

The background image is a close-up of a printed circuit board (PCB) with a purple overlay. A central microchip is labeled 'M250214 K1948BK018 M250214'. Other components and labels visible on the board include 'C25', 'R3', 'C12', 'C17', 'C13', 'C16', 'C15', 'C1', 'C26', 'R12', 'C4', 'C21', 'Q01 32MHz', 'Q04', 'QSPI', and 'D01'.

mikron

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**Микросхемы Микрона
промышленного назначения**

	О предприятии	3
	Таблица соответствия наименований интегральных микросхем (ИМС) в реестре ПП РФ №719	4
	Условные обозначения и знаки	8
	Услуги корпусирования	9
	Микроконтроллер RISC-V MIK32 Амур	10
	Несинхронные DC/DC преобразователи (Step-Down Switching Regulator)	11
	Биполярные LDO регуляторы напряжения	13
	КМОП LDO регуляторы напряжения	18
	Операционные усилители	20
	Компараторы	21
	Интерфейсные микросхемы	21
	Логические ИС	22
	AC-DC LED драйвер	22
	Контроллеры тока и напряжения	23
	DC-DC LED драйверы	24
	ШИМ контроллеры	26
	Микросхемы импульсных источников питания	26
	Дарлингтоновские ключи с большей нагрузочной способностью	27
	Таймер	28
	Новые продукты и перспективные разработки (на этапе ОКР)	77

Микрон – единственное в Российской Федерации серийное производство микроэлектроники с топологическими нормами до 90 нм, входит в Группу компаний «Элемент», MOEX:ELMT, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 1000 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для автоэлектроники, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

> **1000** типономиналов

> **40** новых
изделий
ежегодно

> **700** клиентов
в России
и мире

Присоединяйтесь!

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

(ИМС) В РЕЕСТРЕ ПП РФ №719

Несинхронные DC/DC преобразователи (Step-Down Switching Regulator)

ИМС 1-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	ИМС 2-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	Номер ТУ 1-го уровня локализации	Номер ТУ 2-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 1-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 2-го уровня локализации	Номер страницы подробного описания
—	МИК7109-3.3, серия GM7109 (МИК7109)	—	ДВУК.431433.328-001ТУ	—	10408100	30
K5361ЕК1АТ	МИК7109-5.0, серия GM7109 (МИК7109)	АДКБ.431420.516ТУ	ДВУК.431433.328-001ТУ	10648182	10408100	30
K5361ЕК1БТ	—	АДКБ.431420.516ТУ	ДВУК.431433.328-001ТУ	10648183	10408100	30
K5361ЕФ1Т	МИК7109-Adj, серия GM7109 (МИК7109)	АДКБ.431420.516ТУ	ДВУК.431433.328-001ТУ	10626944	10408100	30
K5361ЕК2Т	GM7109HV-3.3, серия GM7109HV-xx	АДКБ.431420.517ТУ	ДВУК.431433.328-002ТУ	10624890	10297102	30
K5361ЕК2АТ	GM7109HV-5.0, серия GM7109HV-xx	АДКБ.431420.517ТУ	ДВУК.431433.328-002ТУ	10648180	10297102	30
K5361ЕК2БТ	—	АДКБ.431420.517ТУ	—	10648181	—	30
K5361ЕФ2Т	GM7109HV-Adj, серия GM7109HV-xx	АДКБ.431420.517ТУ	ДВУК.431433.328-002ТУ	10648179	10297102	30
K5361ЕФ3Т	—	АДКБ.431420.558ТУ	—	10717103	—	30

Повышающие/понижающие DC/DC преобразователи

K1329ПН1Т	—	АДКБ.431320.612ТУ	—	10717104	—	36
-----------	---	-------------------	---	----------	---	----

Биполярные LDO регуляторы напряжения

K5361ЕН1Т	МИК1117S-1.5, серия GM1117S (МИК1117S)	АДКБ.431420.518ТУ	ДВУК.431433.326-001ТУ	10648174	10408101	39
K5361ЕН1АТ	МИК1117S-1.8, серия GM1117S (МИК1117S)	АДКБ.431420.518ТУ	ДВУК.431433.326-001ТУ	10648175	10408101	39
K5361ЕН1БТ	МИК1117S-2.5, серия GM1117S (МИК1117S)	АДКБ.431420.518ТУ	ДВУК.431433.326-001ТУ	10648176	10408101	39
K5361ЕН1ДТ	МИК1117S-3.3, серия GM1117S (МИК1117S)	АДКБ.431420.518ТУ	ДВУК.431433.326-001ТУ	10648177	10408101	39
K5361ЕН1ЕТ	МИК1117S-5.0, серия GM1117S (МИК1117S)	АДКБ.431420.518ТУ	ДВУК.431433.326-001ТУ	10648178	10408101	39
K5361ЕР1Т	МИК1117S-Adj, серия GM1117S (МИК1117S)	АДКБ.431420.518ТУ	ДВУК.431433.326-001ТУ	10624893	10408101	39

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

(ИМС) В РЕЕСТРЕ ПП РФ №719

Биполярные LDO регуляторы напряжения

ИМС 1-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	ИМС 2-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	Номер ТУ 1-го уровня локализации	Номер ТУ 2-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 1-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 2-го уровня локализации	Номер страницы подробного описания
K5361EP3BT	—	АДКБ.431420.556ТУ	—	10759974	—	47
K5361EP3ГТ	—	АДКБ.431420.556ТУ	—	10759975	—	47
K5361EH3ГТ	—	АДКБ.431420.613ТУ	—	10717101	—	41
K5361EH3ДТ	—	АДКБ.431420.613ТУ	—	10717102	—	41
K5361EH5Т	—	АДКБ.431422.715ТУ	—	10759978	—	48
K5361EH5АТ	—	АДКБ.431422.715ТУ	—	10759979	—	48
—	GM4275TC5RG	—	ДВУК.431433.329-001ТУ	—	10297106	40
—	GM4275TA5RG	—	ДВУК.431433.329-001ТУ	—	10297105	40
K5361EH2ГТ	—	АДКБ.431420.555ТУ	—	10759981	—	46
K5361EP2ГТ1	—	АДКБ.431420.555ТУ	—	10759977	—	46
K5361EP3Т	—	АДКБ.431420.555ТУ	—	10759980	—	46

КМОП LDO регуляторы напряжения

ИМС 1-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	ИМС 2-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	Номер ТУ 1-го уровня локализации	Номер ТУ 2-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 1-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 2-го уровня локализации	Номер страницы подробного описания
K5361EH4БТ	—	АДКБ.431420.614ТУ	—	10624891	—	50
K5361EH4ГТ	—	АДКБ.431420.614ТУ	—	10717109	—	50

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ

(ИМС) В РЕЕСТРЕ ПП РФ №719

КМОП LDO регуляторы напряжения

ИМС 1-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	ИМС 2-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	Номер ТУ 1-го уровня локализации	Номер ТУ 2-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 1-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 2-го уровня локализации	Номер страницы подробного описания
—	GM6250H-3.3, серия GM6250 (MIK6250)	—	ДВУК.431433.334-001ТУ	—	10848603	50
—	GM6250H-5.0, серия GM6250 (MIK6250)	—	ДВУК.431433.334-001ТУ	—	10848603	50

Операционные усилители

К740УД1Т	GM358S8RG	АДКБ.431130.529ТУ	ДВУК.431433.324-003ТУ	10717105	10297100	53
К740УД1Т1	—	АДКБ.431130.529ТУ	—	10717107	—	53
К740УД2Т	—	АДКБ.431130.538ТУ	—	10759973	—	54

Компараторы

К597СА1Т	GM393S8RG	АДКБ.431350.530ТУ	ДВУК.431433.324-004ТУ	10717106	10297101	57
К597СА1Т1	—	АДКБ.431350.530ТУ	—	10717108	—	57

Интерфейсные микросхемы

К5361BB2Т (256 узлов)	GM485 (32 узла)	АДКБ.431290.515ТУ	ДВУК.431433.324-002ТУ	10624894	10823050	61
К5361BB1Т	GM3485	АДКБ.431290.514ТУ	ДВУК.431433.324-001ТУ	10626945	10823049	62
К5659ИН1Т	—	АДКБ.431230.610ТУ	—	10880694	—	60

AC-DC LED драйвер

К1483ХБ1Т	—	АДКБ.431290.539ТУ	—	10759976	—	67
-----------	---	-------------------	---	----------	---	----

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (ИМС) В РЕЕСТРЕ ПП РФ №719

Контроллеры тока и напряжения

ИМС 1-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	ИМС 2-го уровня локализации ПП РФ №719, ПП РФ №878	Номер ТУ 1-го уровня локализации	Номер ТУ 2-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 1-го уровня локализации	Номер реестровой записи для ИМС 2-го уровня локализации	Номер страницы подробного описания
K5011EP2T (точность 0,5%, инверсный)	–	АДКБ.431420.607ТУ	–	10626948	–	69
K5011EP2AT (точность 1%, инверсный)	–	АДКБ.431420.607ТУ	–	10626949	–	69
K5011EP1T (точность 0.5%, прямой)	GM431SAST23RG	АДКБ.431420.607ТУ	ДВУК.431433.327-002ТУ	10626946	10297103	69
K5011EP1AT (точность 1%, прямой)	–	АДКБ.431420.607ТУ	–	10626947	–	69
K5361EP2T	GM432 (MIK432)	АДКБ.431420.519ТУ	ДВУК.431433.327-001ТУ	10624892	10408099	69
–	GM5510C-2.7 , серия GM5510C-xx	–	ДВУК.431433.327-003ТУ	–	10297104	70
–	GM5510C-2.9 , серия GM5510C-xx	–	ДВУК.431433.327-003ТУ	–	10297104	70
–	GM5510C-3.3 , серия GM5510C-xx	–	ДВУК.431433.327-003ТУ	–	10297104	70

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- Изделия отечественного производства 1-го уровня локализации (разработка и производство РФ), имеющие действующую реестровую запись в государственной информационной системе промышленности (ГИСП), с актом экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП) согласно Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 (ПП РФ №719). Применение микросхем 1-го уровня локализации обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.



- Изделия отечественного производства 2-го уровня локализации, имеющие действующую реестровую запись в ГИСП, с актом экспертизы ТПП согласно ПП РФ №719 от 17 июля 2015 года. Применение микросхем 2-го уровня локализации обеспечивает меньшее количество баллов при оценке локализации продукции, чем применение микросхем 1-го уровня.



- Микросхемы категории качества ОТК (отдел технического контроля).



- Рабочий температурный диапазон микросхемы в пластиковом корпусе.



В серии, ПП РФ №719.



В освоении, ПП РФ №719.



Изделие на этапе разработки (ОКР).

Проверить действующие реестровые записи: gisp.gov.ru



= максимум баллов при оценке локализации продукции.

УСЛУГИ КОРПУСИРОВАНИЯ

АО «Микрон» предлагает услуги по сборке кристаллов микросхем в пластиковые корпуса различного назначения.

№ п/п	Освоенные корпуса АО «Микрон»	Максимальный размер кристалла
1	QFN64	6.0×6.0 мм х мм
2	SO-16	3.2×2.1 мм х мм
3	ESOP-8	3.1×2.2 мм х мм
4	SOT-223	2.8×2.5 мм х мм
5	TO-252-5	4.8×3.6 мм х мм
6	TO-247	10.0×5.0 мм х мм
7	SO-8	3.1×2.2 мм х мм
8	SOIC-16 (с двумя кристаллодержателями)	3–3.5×1.5 мм х мм
9	VSSOP-8	1.4×1.1 мм х мм
10	SOT-23-3	1.6×1.1 мм х мм
11	TO-263-5	6.7×4.4 мм х мм
12	QFN104	7.5×7.5 мм х мм

Примечание

Максимально допустимые размеры даны без учета возможного растекания клея.

Установка кристалла производится на токопроводящий клей или мягкий припой (для корпусов серии TO-xxx).

Разварка кристалла производится золотой (18 и 25 мкм), медной (25, 38 и 50 мкм) или алюминиевой проволокой (75 и 500 мкм).

Толщина проволоки может быть изменена по желанию Заказчика.

Программа тестирования (100% выходной контроль) предоставляется Заказчиком.

Финишное покрытие выводов – NiPdAu.

Пластины для сборки в корпуса утоняются до 300 мкм (кроме QFN64). В случае сборки в QFN64 – до 200 мкм.

Материалы, необходимые для запуска в производство

- Сборка
- Схема разварки
- Информация о проволоке
- Информация о требуемом материале для монтажа кристалла

Тестирование

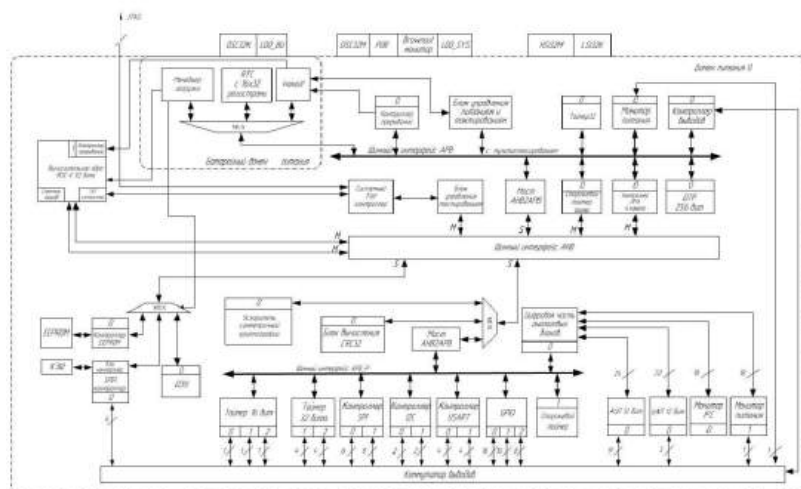
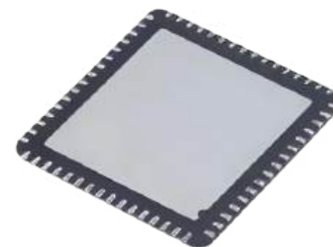
- Схема включения для функционального тестирования
- Параметры функционального тестирования
- Информация об измерениях

Информация о кристалле

- Координаты и размер контактных площадок кристалла
- Размер кристалла
- Материал контактных площадок кристалла
- Информация о наличии компонентов под контактными площадками кристалла

K1948BK015/018 (МК32 Амур)

Микроконтроллер



в серии, 719ПП

Найти
в реестре ГИСП



Заказать на сайте



Ядро:

- RISC-V.

Интерфейсы:

- SPI, I2C, UART, датчик температуры;
- АЦП 12 бит, 8 каналов, частота дискретизации до 1 МГц;
- ЦАП 12 бит, 2 канала, частота дискретизации до 1 МГц;
- Часы реального времени с поддержкой полного календаря;
- Поддерживаемые частоты опорного тактового сигнала 1-32 МГц;
- Watchdog.

Память:

- ОПЗУ (однократно программируемая ПЗУ) – 256 бит;
- ОЗУ – 16 КБ;
- ПЗУ (EEPROM) – 8 КБ;
- Подключаемая внешняя память программ (QSPI Flash) – прямой доступ на чтение до 2 Гбайт с кэш 1 Кбайт и до 4 Гбайт непрямого доступа на чтение/запись без кэша;
- Кэш памяти внешней шины памяти программ – 1 КБ.

Таймеры:

- Таймеры 16- и 32-разрядов с поддержкой ШИМ, захвата/сравнения сигналов.

Особенности:

- Аппаратная поддержка крипто-алгоритмов ГОСТ 34.12–2018 и AES128;
- Рабочие температуры -40...+85°C;
- Корпус QFN64.

Несинхронные DC-DC преобразователи (Step-Down Switching Regulator)							
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	F _{sw} [KHz]	Корпус	Подробное описание
MIK7109 – Импульсный понижающий стабилизатор напряжения*							
–	MIK7109-3.3, серия GM7109 (MIK7109)	40	3.3	3	150	4303.8-C.01 K (ESOP-8)	30
K5361EK1AT	MIK7109-5.0, серия GM7109 (MIK7109)		5				
K5361EK1BT	–		12				
K5361EФ1T	MIK7109-Adj, серия GM7109 (MIK7109)		Adj				
MIK7109HV – Понижающий DC-DC преобразователь*							
K5361EK2T	GM7109HV-3.3 серия GM7109HV-xx	60	3.3	3	150	4303.8-C.01 K (ESOP-8)	30
K5361EK2AT	GM7109HV-5.0 серия GM7109HV-xx		5				
K5361EK2BT	–		12				
K5361EФ2T	GM7109HV-Adj серия GM7109HV-xx		Adj				
MIK7230 – Импульсный понижающий стабилизатор напряжения*							
K5361EK1AT1 В процессе внесения в реестр ³	–	40	5	3	150	4801.5-1 K (TO-263-5)	31
K5361EФ1T1 В процессе внесения в реестр ³	–		Adj				
MIK7230HV – Понижающий DC-DC преобразователь*							
K5361EФ2T1 В процессе внесения в реестр ³	–	60	Adj	3	150	4801.5-1 K (TO-263-5)	31

* – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	F _{SW} [KHz]	Корпус	Подробное описание
MIK45419 – Понижающий DC-DC преобразователь*							
K5361EФ3Т	–	30	Adj	2	600	4303.8-С.01 К (ESOP-8)	35
MIK4573 – Понижающий DC-DC преобразователь*							
K5361EФ4Т В процессе внесения в реестр ³	–	40	Adj	3	300	4802.5-А К (ТО-252-5)	32
MIK7102SV – Понижающий DC-DC преобразователь*							
В процессе внесения в реестр ³	–	80	Adj	0.2	150	4303.8-С.01 К (ESOP-8)	33
MIK1501В – Импульсный понижающий стабилизатор напряжения*							
В процессе внесения в реестр ³	–	40	Adj	5	300	ТО-263-5	34
MIK2576 – Понижающий DC-DC преобразователь*							
MIK2576 ⁴		40	3.3; 5; 12; Adj	2	52	4303.8-С.01 К (ESOP-8)	mikron.ru
MIK7130 – Понижающий DC-DC преобразователь*							
MIK7130 ⁴		40	3.3; 5; 12; Adj	3	52	4801.5-1 К (ТО-263-5)	mikron.ru
MIK7130HV – Понижающий DC-DC преобразователь*							
MIK7130HV ⁴		60	3.3; 5; 12; 15; Adj	3	52	4801.5-1 К (ТО-263-5)	mikron.ru
MIK9130HV – Понижающий DC-DC преобразователь*							
MIK9130HV ⁴		60	3.3; 5; 12; 15; Adj	3	52	4303.8-С.01 К (ESOP-8)	mikron.ru

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Повышающие/понижающие DC-DC преобразователи							
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	F _{sw} [KHz]	Корпус	Подробное описание
МІК34063 – Понижающий/повышающий инвертирующий DC-DC преобразователь*							
K1329PH1T	–	40	Adj	1.5	100	4303.8-С.01 К (ESOP-8)	36
МІК7015 – 1А/80V регулируемый, понижающий DC-DC преобразователь*							
МІК7015 В процессе внесения в реестр ³	–	80	Adj	1	150	4303.8-С.01 К (ESOP-8) TO-263-5	37
Биполярные LDO регуляторы напряжения							
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
МІК1117S – LDO стабилизатор положительного напряжения*							
K5361EH1T	МІК1117S-1,5 , серия GM1117S (МІК1117S)	20	1.5	1	1.2	4342.3-1 К (SOT-223)	39
K5361EH1AT	МІК1117S-1,8 , серия GM1117S (МІК1117S)		1.8				
K5361EH1BT	МІК1117S-2,5 , серия GM1117S (МІК1117S)		2.5				
K5361EH1DT	МІК1117S-3,3 , серия GM1117S (МІК1117S)		3.3				
K5361EH1ET	МІК1117S-5,0 , серия GM1117S (МІК1117S)		5				
K5361EP1T	МІК1117S-Adj , серия GM1117S (МІК1117S)		Adj				

* – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
MIK4275 – LDO стабилизатор напряжения*							
K5361EP1T1 В процессе внесения в реестр ³	GM4275TC5RG	5.5 ~ 42	5	0.45	0.25	4802.5-A K (TO-252-5)	40
K5361EP1T В процессе внесения в реестр ³	GM4275TA5RG					4801.5-1 K (TO-263-5)	
MIK6610x – LDO стабилизатор напряжения*							
MIK66100							
K5361EH2ГТ	—	2.25 ~ 16	3.3	1	0.41	4342.3-1 K (SOT-223)	46
K5361EH2ДТ В процессе внесения в реестр ³	—		5				
MIK66101							
В процессе внесения в реестр ³	—	2.25 ~ 16	1.8	1	0.41	4303.8-C.01 K (ESOP-8)	46
В процессе внесения в реестр ³	—		2.5				
K5361EP2ГТ1	—		3.3				
K5361EP2ДТ1 В процессе внесения в реестр ³	—		5				
MIK66102							
K5361EP3Т	—	2.25 ~ 16	Adj	1	0.41	4303.8-C.01 K (ESOP-8)	46

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
MIK6615x – LDO стабилизатор напряжения высокой точности*							
MIK66151							
K5361EP4AT В процессе внесения в реестр ³	–	2.3 ~ 26	3.3	1.5	0.35	4801.5-1 К (TO-263-5)	44
K5361EP4BT В процессе внесения в реестр ³	–		5				
MIK66152							
K5361EP4T В процессе внесения в реестр ³	–	2.3 ~ 26	Adj	1.5	0.35	4801.5-1 К (TO-263-5)	44
MIK295x – LDO стабилизатор напряжения с защитой от перенапряжения*							
MIK2951							
K5361EP3BT	–	2.3 ~ 30	3.3	0.1	0.38	4303.8-С К (SO-8)	47
K5361EP3GT	–		5				
В процессе внесения в реестр ³	–		Adj				
MIK2930x – LDO стабилизатор напряжения*							
MIK29301							
K5361EP5GT В процессе внесения в реестр ³	–	2.3 ~ 26	3.3	3	0.37	4801.5-1 К (TO-263-5)	45
K5361EP5DT В процессе внесения в реестр ³	–		5				
MIK29302							
K5361EP5T В процессе внесения в реестр ³	–	2.3 ~ 26	Adj	3	0.37	4801.5-1 К (TO-263-5)	45

* – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
MIK2940HV – Линейный LDO стабилизатор напряжения с высокой точностью*							
K5361EH3ГТ	–	60	3.3	1	0.4	4342.3-1 K (SOT-223)	41
K5361EH3ДТ	–		5				
K5361EH3ИТ В процессе внесения в реестр ³	–		12				
MIK2985 – Малошумящий линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения*							
В процессе внесения в реестр ³	–	2.5 ~ 16	3.3	0.15	0.2	4343.3-1 K (SOT-23-3)	42
В процессе внесения в реестр ³	–		5				
MIK9076 – LDO стабилизатор напряжения с сверхнизким током покоя и задержкой выходного сигнала сброса*							
K5361EH5Т	–	5.35 ~ 40	3.3	0.15	0.2	4303.8-C.01 K (ESOP-8)	48
K5361EH5АТ	–		5				
MIK317 – Стабилизатор напряжения*							
–	MIK317TA3RG В процессе внесения в реестр ³	3 ~ 40	1.2 ~ 37.0	1.5	2	TO-263-3	43
MIK2950x – LDO стабилизатор напряжения с защитой от перенапряжения*							
MIK2950x		20	1.5 ~ 12; Adj	5	0.45	TO-252-2L	47
MIK5213 – LDO стабилизатор напряжения*							
MIK5213 ⁴		2.5 ~ 16	2.5 ~ 5	0.08	0.3	SOT-23-5L	mikron.ru

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
MIK6155 – Малошумящий LDO стабилизатор напряжения*							
MIK6155 ⁴		2 ~ 16	1.5 ~ 12, Adj	0.15	0.165	SOT-23-5	mikron.ru
MIK8005/MIK8015 – LDO стабилизатор напряжения*							
MIK8005/MIK8015 ⁴		35	3.3 ~ 15, Adj	0.4	0.42	4802.5-A K (TO-252-5)	mikron.ru
MIK2940 – Линейный LDO стабилизатор напряжения с высокой точностью*							
MIK2940 ⁴		26	1.5 ~ 5; Adj	1	0.4	4801.5-1 K (TO-263-5)	41
MIK2954 – Линейный LDO стабилизатор напряжения*							
MIK2954 ⁴		2.3 ~ 30	2.5; 3.3; 5	0.25	0.06 ~ 0.47	4801.5-1 K (TO-263-5)	mikron.ru
MIK2915x – LDO Стабилизатор напряжения*							
MIK2915x ⁴		20	1.5 ~ 12; Adj	1.5	0.45	4802.5-A K (TO-252-5)	mikron.ru
MIK1085 – LDO стабилизатор положительного напряжения*							
MIK1085 ⁴		2.5 ~ 15	1.5 ~ 5; Adj	3	1.5 (при 3A)	4802.5-A K (TO-252-5)	mikron.ru
MIK66302 – ULTRA LDO стабилизатор напряжения*							
MIK66302 ⁴		2.5 ~ 16	1.5 ~ 5; Adj	3	0.385	4801.5-1 K (TO-263-5)	mikron.ru
MIK6605 – LDO стабилизатор положительного напряжения*							
MIK6605 ⁴		2.5 ~ 15	1.5 ~ 5; Adj	5	1.5 (при 5A)	TO-263, 4802.5-A K (TO-252-5)	mikron.ru
MIK6603 – LDO стабилизатор положительного напряжения*							
MIK6603 ⁴		2.5 ~ 15	1.5 ~ 5; Adj	3	1.5 (при 3A)	4801.5-1 K (TO-263-5)	mikron.ru

*** – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».**

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	$V_{IN(MAX)}$ [V]	V_{OUT} [V]	$I_{OUT(MAX)}$ [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
MIK66015 – LDO стабилизатор положительного напряжения*							
MIK66015 ⁴		2.5 ~ 15	1.5 ~ 5; Adj	5	1,5 (при 1.5A)	4342.3-1 K (SOT-223)	mikron.ru
MIK66500(1) – LDO стабилизатор напряжения*							
MIK66500(1) ⁴		2.25 ~ 16	1.8 ~ 5; Adj	5	0.4	4801.5-1 K (TO-263-5)	mikron.ru
MIK6250L – LDO Стабилизатор напряжения*							
MIK6250L ⁴		2.5 ~ 12	1.0 ~ 6.0	0.5	0.4 ~ 0.9	4343.3- 1 K (SOT-23-3)	mikron.ru
MIK78x.x – LDO стабилизатор положительного напряжения*							
MIK78x.x ⁴		7.0 (MIK7805) ~ 40 (MIK7827)	5	1,5	2	4802.5-A K (TO-252-5)	mikron.ru
КМОП LDO регуляторы напряжения							
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	$V_{IN(MAX)}$ [V]	V_{OUT} [V]	$I_{OUT(MAX)}$ [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
MIK6250 – LDO Стабилизатор напряжения*							
K5011EH1.8T В процессе внесения в реестр ³	—	2.5 ~ 12	1.8	0.5	0.4	4343.3- 1 K (SOT-23-3)	50
K5011EH3.3T В процессе внесения в реестр ³	—		3.3				
K5011EH5.0T В процессе внесения в реестр ³	—		5				

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN(MAX)} [V]	V _{OUT} [V]	I _{OUT(MAX)} [A]	Напряжение падения [V]	Корпус	Подробное описание
MIK6250H – КМОП LDO стабилизатор напряжения*							
K5361EH4BT	—	2.7 ~ 25	3.3	0.25	0.7	4343.3- 1 K (SOT-23-3)	50
K5361EH4GT	—		5				
—	GM6250H-3.3, серия GM6250 (MIK6250)		3.3			SOT-89	
—	GM6250H-5.0, серия GM6250 (MIK6250)		5				
MIK6350 – LDO стабилизатор положительного напряжения*							
MIK6350 ⁴		2.5 ~ 6.5	1.5 ~ 6.0	0.3	0.1 ~ 0.45	4342.3-1 K (SOT-223)	mikron.ru
MIK6355 – КМОП LDO стабилизатор напряжения*							
MIK6355 ⁴		2 ~ 8	0.9 ~ 6.0; Adj	0.3	0.3	4342.3-1 K (SOT-223)	mikron.ru
MIK6655 – КМОП LDO стабилизатор напряжения*							
В процессе внесения в реестр ³	—	2.1 ~ 7	1.8	0.6	0.6	4342.3-1 K (SOT-223)	51
В процессе внесения в реестр ³	—		3.3				
В процессе внесения в реестр ³	—		5				
MIK75HK – КМОП LDO стабилизатор напряжения*							
MIK75HK ⁴		2.7 ~ 30	2.5 ~ 5	0.1	0.6	4343.3- 1 K (SOT-23-3)	mikron.ru

* – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Операционные усилители							
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	Supply Voltage V _{CC} [V]	Input Offset V _{io_max} [mV]	Differential input V [V] ^(DIFF)	Input Voltage V _{IN} (V)	Корпус	Подробное описание
MIK358 – Сдвоенный операционный усилитель*							
K740УД1Т	GM358S8RG	40 или ±16	7	40	-0.3 ~ 36	4303.8-С К (SO-8)	53
K740УД1Т1	–					4344.8-1К (VSSOP-8)	
MIKOP07 – Одиночный прецизионный операционный усилитель*							
K740УД2Т	–	36 или ±18	0.06	±30	-0.3 ~ 40	4303.8-С К (SO-8)	54
MIK324 – Четверенный операционный усилитель*							
–	MIK324S14RG В процессе внесения в реестр ³	36 или ±18	7	36	±10	SO-14	55
MIK4558 – Малошумящий сдвоенный операционный усилитель*							
MIK4558 ⁴		±10	5	±22	±14	4303.8-С К (SO-8)	mikron.ru
MIK386 – Низковольтный одиночный усилитель низкой частоты (аудио)*							
MIK386 ⁴		15 (Absolute)	Gain=46dB/BW=30kHz/ THD=0.2%		±0.3 (Absolute)	4303.8-С К (SO-8)	mikron.ru

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Компараторы									
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	Supply Voltage [V]	Differential input V _{I(DIFF)} [V]	Input Voltage V _{IN} (V)	Input Offset V _{io} [mV]	Input Offset Current [mV]	Input Bias Current [nA]	Корпус	Под- робное описа- ние
МИК393 – Сдвоенный дифференциальный компаратор*									
K597CA1T	GM393S8RG	±18 либо 36	36	-0.3 ~ 36	2	5	-25	4303.8-CK (SO-8)	57
K597CA1T1	—							4344.8-1K (VSSOP-8)	
МИК339 – Счетверенный дифференциальный компаратор*									
—	МИК339S14RG В процессе внесения в реестр ³	±18 либо 36	36	-0.3 ~ 36	2	5	-25	SO-14	58
Интерфейсные микросхемы									
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	Supply Voltage [V]	Supply Curent [mA]	Кол-во каналов	Скорость [kbps]	ESD Voltage [kV]	Корпус	Подробное описание	
МИК485 – Полудуплексный RS-485 трансивер*									
K5361BB2T	GM485	5	0.9	1	5 000	15	4303.8-С К (SO-8)	61	
МИК3485 – RS-485 трансивер малой мощности*									
K5361BB1T	GM3485	3.3	0.5	1	10 000	15	4303.8-С К (SO-8)	62	
МИК3232 – RS-232 трансивер*									
K5659ИН1T	—	3.3 ~ 5	0.3	2	250	15	4307.16-D К (SOP-16)	60	

* – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Логические ИС									
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{CC(MIN)} [V]	V _{CC(MAX)} [V]	Кол-во каналов	Ток нагрузки [mA]	Ток покоя [µA]	tPD при VCC=4.5V [nS]	Корпус	Подробное описание
MIK74HC04 – Шесть логических элементов «НЕ»*									
–	MIK74HC04S14RG В процессе внесения в реестр ³	2	6	6	4	20	9	SO-14	64
MIK74HC14 – Инвертирующий триггер Шмитта*									
–	MIK74HC14 В процессе внесения в реестр ³	2	6	6	4	20	15	SO-14	65
MIK74HC00 – Четыре логических элемента «2И-НЕ»*									
MIK74HC00 ⁴		2	6	4	4	20	9	SO-14	mikron.ru
AC-DC LED драйвер									
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{SUPPLY} [V]	Рабочая частота [kHz]	I _{OUT} [A]	Управление диммированием	Корпус	Подробное описание		
MIK9910B – Универсальный понижающий драйвер LED высокой яркости с контролем димминга*									
K1483XB1T	–	10 ~ 600	300	1	ШИМ / линейное	4303.8-С К (SO-8)	67		

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Контроллеры тока и напряжения							
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{REF} [V]	V _{KA} [V]	I _{KA (MIN)} [mA]	I _{KA(MAX)} [mA]	Корпус	Подробное описание
MIK431 – Регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор*							
K5011EP2T (точность 0,5%, инверсный)	—	2.5	36	1	100	4343.3- 1 K (SOT-23-3)	69
K5011EP2AT (точность 1%, инверсный)	—						
K5011EP1T (точность 0.5%, прямой)	GM431SAST23RG						
K5011EP1AT (точность 1%, прямой)	—						
MIK432 – Регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор*							
K5361EP2T	GM432 (MIK432)	1.24	16	0.08	100	4343.3- 1 K (SOT-23-3)	69
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{CC} [V]	V _{REF (OUT)} [V]	V _{OUT} [V]	Частота единичного усиления [MHz]	Корпус	Подробное описание
MIK103A – Сдвоенный операционный усилитель и источник опорного напряжения*							
MIK103A ⁴		3 ~ 36	2.5	0 ~ (Vcc-1.5)	1	4303.8-С К (SO-8)	mikron.ru
MIK4300 – Регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор*							
MIK4300 ⁴		3 ~ 18	2.5/1.24	0 ~ (Vcc-1.5)	1	4303.8-С К (SO-8)	mikron.ru

* – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN} [V]	V _{REF} [V]	I _{OUT} [mA]	ΔV _{REF} [mV]	Корпус	Подробное описание
MIK580 – Прецизионный источник опорного напряжения*							
MIK580 ⁴		30	2.5; 5; 10.0	20	±10; ±20; ±40	4303.8-С К (SO-8)	mikron.ru
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN} [V]	Детекти- руемое напряжение	I _{OUT} [mA]	tDLY [Ms]	Корпус	Подробное описание
MIK5510C – Прецизионный датчик напряжения с низким энергопотреблением*							
K1483ДН2.7А1Т В процессе внесения в реестр ³	GM5510C-2.7, серия GM5510C-xx	2.7	1.6 ~ 6.0 с шагом 0.1	2.2 ~ 13	0.03	4343.3- 1 К (SOT-23-3)	70
K1483ДН2.9А1Т В процессе внесения в реестр ³	GM5510C-2.9, серия GM5510C-xx	2.9					
K1483ДН3.3А1Т В процессе внесения в реестр ³	GM5510C-3.3, серия GM5510C-xx	3.3					
DC-DC LED драйверы							
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN} [V]	V _{OUT} [V]	I _{SW/OUT} (Switch Current Limit / Average current) [mA]	Рабочая частота [MHz]	Корпус	Подробное описание
MIK402UK – Линейный LED драйвер*							
MIK402UK ⁴		5 ~ 40	38.0	65	—	SOT-23-6	mikron.ru

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN} [V]	V _{OUT} [V]	I _{SW/OUT} (Switch Current Limit / Average current) [mA]	Рабочая частота [MHz]	Корпус	Подробное описание
MIK19371 – Повышающий преобразователь для питания белых светодиодов с OVP*							
MIK19371 ⁴		10	36.0	320	1.6	SOT-23-6	mikron.ru
MIK1937 – Повышающий преобразователь для питания белых светодиодов*							
MIK1937 ⁴		2.5 ~ 18	30.0	650	1.2	SOT-23-5	mikron.ru
MIK69231(3) – ИС контроллера 3-х сегментного LED драйвера с питанием от сети переменного тока*							
MIK69231(3) ⁴		10	36.0	320	1.2	TO-252-5L	mikron.ru
MIK8181 – ИС двухканального LED драйвера с функцией обнаружения неисправностей*							
MIK8181 ⁴		5 ~ 400	–	3 X 100	–	4303.8-C.01 K (ESOP-8)	mikron.ru
MIK9601 – Драйвер светодиодов высокой яркости с коррекцией коэффициента мощности*							
MIK9601 ⁴		6 ~ 42	1.5 ~ 37.0	110	4.5 (kHz)	4303.8-C.01 K (ESOP-8)	mikron.ru
MIK9623 – 350 мА, высоковольтный светодиодный драйвер со встроенным силовым полевым транзистором*							
MIK9623 ⁴		50 ~ 700	8.0	800	0.5	4802.5-A K (TO-252-5)	mikron.ru
MIK1210 – Регулятор для LED освещения (Встроенная настройка выходного тока для различной яркости светодиодов)*							
MIK1210 ⁴		50	200	100 ~ 300	–	SOT-23-6	mikron.ru

*** – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».**

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

ШИМ контроллеры								
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN} [V]	Рабочий цикл [%]	Рабочая частота, кГц	Корпус	Подробное описание		
МІК384х – ШИМ контроллер с регулировкой по току*								
МІК3842								
В процессе внесения в рестр ³	–	30	50/100	500	4303.8-С К (SO-8)	72		
МІК1217 – ШИМ-контроллер с регулировкой по току для высоковольтных источников питания*								
МІК1217 В процессе внесения в рестр ³	–	500	80	100	4303.8-С К (SO-8)	73		
МІК7500 – ШИМ контроллер*								
МІК7500 ⁴		7 ÷ 40	45 (на канал)	200	4307.16-D К (SOP-16)	mikron.ru		
Микросхемы импульсных источников питания								
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN} [V]	230 VAC ±15% (Адаптер/ Открытая рамка) [W]	85-265 VAC (Адаптер/ открытая рамка) [W]	Топология	Рабочая частота, кГц	Корпус	Подробное описание
МІК364 – ИС импульсного источника питания с низким энергопотреблением*								
В процессе внесения в реестр ³	–	85 ~ 265	5.5/9	4/6	Обратно- ходовой	150	4303.8-С К (SO-8)	75

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{IN} [V]	VFB	Рабочий цикл [%]	Рабочая частота [kHz]	Корпус	Подробное описание
--	--	---------------------	-----	---------------------	--------------------------	--------	-----------------------

MIK911 – контроллер высоковольтного импульсного стабилизатора напряжения, со встроенным MOSFET*							
В процессе внесения в рестр ³	–	85 ~ 265	1	0 ~ 5(ЧИМ)/ 5 ~ 85 (ШИМ)	90	4303.8-С К (SO-8)	76

MIK5001 – ШИМ-контроллер с функциями SCP/DTC*							
MIK5001 ⁴		3.6 ~ 16	1	–	500	4303.8-С К (SO-8)	mikron.ru

Дарлингтоновские ключи с большей нагрузочной способностью

Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{CE} [V]	V _{IN} [V]	Ток коллектора [mA]	V _{CE(SAT)} [V]	IIN(ON) [mA]	V _{I(NON)} [V]	Корпус	Подробное описание
--	--	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	--------	-----------------------

ULN2003A – Матрица из семи транзисторов Дарлингтона*									
ULN2003A ⁴		50	30	500	1.3 при IC=300mA	0.93 при VI = 3.85V	3 при IC=300 mA	4307.16-D К (SOP-16)	mikron.ru

ULN2003 – Матрица из семи транзисторов Дарлингтона*									
ULN2003 ⁴		40	30	500	1.3 при IC=300mA	0.93 при VI = 3.85V	3 при IC=300 mA	4307.16-D К (SOP-16)	mikron.ru

ULN2004A – Матрица из семи транзисторов Дарлингтона*									
ULN2004A ⁴		50	30	500	1.3 при IC=300mA	0.93 при VI = 3.85V	3 при IC=300 mA	4307.16-D К (SOP-16)	mikron.ru

ULN2803A – Матрица из восьми транзисторов Дарлингтона*									
ULN2803A ⁴		50	30	500	1.3 при IC=300mA	0.93 при VI = 3.85V	3 при IC=300 mA	4307.16-D К (SOP-16)	mikron.ru

* – По вопросам заказа микросхем в других исполнениях просьба обращаться в отдел продаж/отдел технической поддержки АО «Микрон».

¹ 1-й уровень локализации (ГИСП): полный цикл производства (разработка, корпусирование, тестирование) выполнен на территории РФ. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

² 2-й уровень локализации (ГИСП): частичная локализация в РФ с существенной долей отечественных компонентов. Микросхема соответствует ПП РФ № 719 и внесена в реестр ГИСП.

Таймер									
Название ИМС 1 уровня локализации ¹	Название ИМС 2 уровня локализации ²	V _{CC_MIN} [V]	V _{CC_MAX} [V]	F _{OSC_MAX} [kHz]	I _{CC_TUP} [uI]	I _{O(MAX)} [mA]	V _{OL_MAX} при V _{CC} = 15V [V]	Корпус	Подробное описание
MIK555 – Цепь точной калибровки времени*									
MIK555 ⁴		2	18	500	300	200	1	4303.8-С К (SO-8)	mikron.ru

³ Микросхема находится в процессе включения в реестр ГИСП с последующим присвоением названия, соответствующего уровню локализации. Актуальную информацию о статусе запрашивайте в отделе продаж или технической поддержки АО «Микрон».

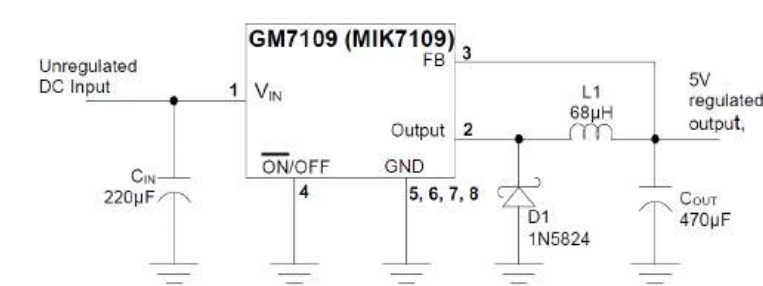
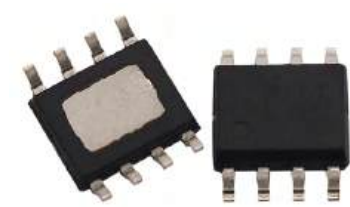
⁴ Изделия с локализованным производством полупроводникового кристалла.

➤ **НЕСИНХРОННЫЕ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (STEP-DOWN SWITCHING REGULATOR)**

НЕСИНХРОННЫЕ DC/DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (STEP-DOWN SWITCHING REGULATOR)

MIK7109, MIK7109HV

Понижающий DC-DC преобразователь с Uвх до 60В



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
-	MIK7109-3.3, серия GM7109 (MIK7109)	ДВУК.431433.328-001ТУ
K5361EK1AT	MIK7109-5.0, серия GM7109 (MIK7109)	АДКБ.431420.516ТУ/ ДВУК.431433.328-001ТУ
K5361EK1BT (Vout=12V)	-	АДКБ.431420.516ТУ
K5361EФ1T	MIK7109-Adj, серия GM7109 (MIK7109)	АДКБ.431420.516ТУ/ ДВУК.431433.328-001ТУ
K5361EK2T	GM7109HV-3.3, серия GM7109HV-xx	АДКБ.431420.517ТУ/ ДВУК.431433.328-002ТУ
K5361EK2AT	GM7109HV-5.0, серия GM7109HV-xx	АДКБ.431420.517ТУ/ ДВУК.431433.328-002ТУ
K5361EK2BT (Vout=12V)	-	АДКБ.431420.517ТУ
K5361EФ2T	GM7109HV-Adj, серия GM7109HV-xx	АДКБ.431420.517ТУ/ ДВУК.431433.328-002ТУ

В серии, ПП РФ №719.

Заказать на сайте



Найти в реестре ГИСП



Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

Основные характеристики:

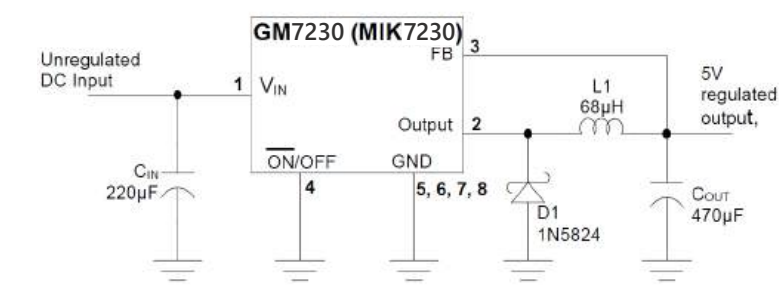
- Диапазон входного напряжения 5.5-40В (60В для 7109HV);
- Выходной ток до 3А (пиковый ток через ключ ~5.5А);
- Версии с регулируемым выходным напряжением и с фиксированным (3.3В и 5В);
- Рабочая частота 150кГц;
- Вход ON/OFF;
- Рабочий диапазон температур: -40°С...+85°С;
- Корпус 4303.8-С.01 К (ESOP-8) с теплоотводящим контактом.

Преимущества:

- pin-to-pin аналог – LM2596(HV), LM2591/2/3;
- Минимальное количество внешних компонентов (внутренняя компенсирующая цепь);
- Индустриальный стандарт для данного класса преобразователей.

MIK7230, MIK7230HV

Понижающий DC-DC преобразователь с $U_{вх}$ до 60В



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EK1AT1 (Vout=5V) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.516ТУ
K5361ЕФ1Т1 (Vout=Adj) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.516ТУ
K5361ЕФ2Т1 (Vout=Adj) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.517ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

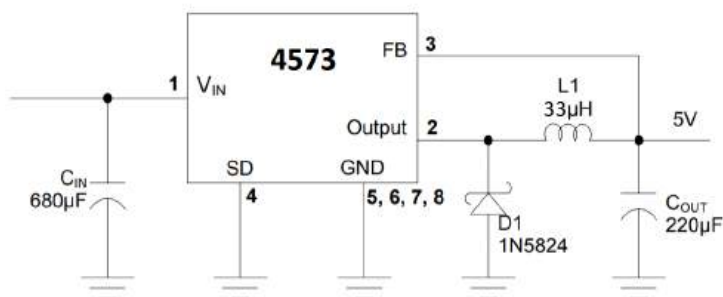
- Диапазон входного напряжения 5.5-40В (60В для 7230HV);
- Выходной ток до 3А (пиковый ток через ключ ~5.5А);
- Версии с регулируемым выходным напряжением и с фиксированным (3.3В и 5В);
- Рабочая частота 150кГц;
- Вход ON/OFF;
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус 4801.5-1 К (ТО-263-5).

Преимущества:

- pin-to-pin аналог LM2596(HV), LM2591/2/3;
- Минимальное количество внешних компонентов (внутренняя компенсирующая цепь);
- Индустриальный стандарт для данного класса преобразователей.

MIK4573

Понижающий DC-DC преобразователь с $U_{вх}$ до 40В
и $F_{sw} = 300\text{кГц}$



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
К5361ЕФ4Т (V _{out} =Adj) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.636ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

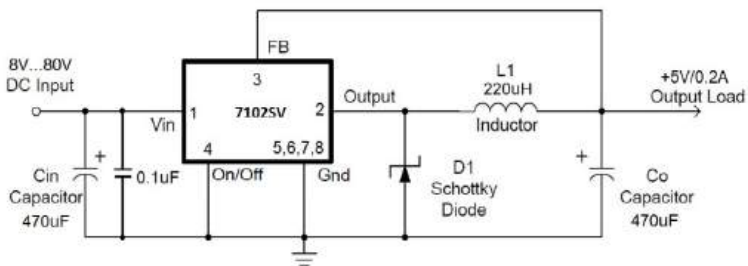
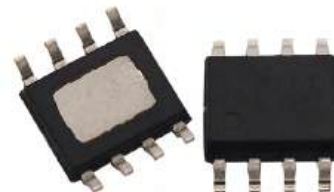
- Диапазон входного напряжения 5.5-40В;
- Выходной ток до 3А (пиковый ток через ключ ~5.7А);
- Версии с регулируемым выходным напряжением и с фиксированным (3.3В, 5В, 12В, 15В);
- Рабочая частота 300кГц;
- Вход ON/OFF;
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус 4802.5-А К (ГО-252-5).

Преимущества:

- pin-to-pin аналог LM2596, LM2591/2/3, МПК7109;
- Минимальное количество внешних компонентов (внутренняя компенсирующая цепь);
- Индустриальный стандарт для данного класса преобразователей.

MIK7102SV

Понижающий DC-DC преобразователь с $U_{вх}$ до 80В



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется (Vout=Adj) в процессе внесения в реестр	-	СП MIK7102SVHV96LK (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

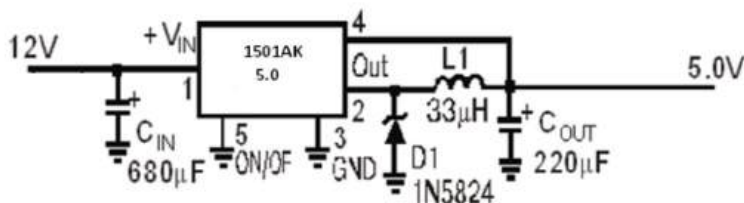
- Диапазон входного напряжения 4.5-80В;
- Выходной ток до 0.2А (пиковый ток через ключ ~0.67А);
- Версии с регулируемым выходным напряжением и с фиксированным (3.3В, 5В);
- Рабочая частота 150кГц;
- Вход ON/OFF;
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус 4303.8-С.01 К (ESOP-8) с теплоотводящим контактом.

Преимущества:

- Совместимость по выводам с другими преобразователями из портфолио в корпусе ESOP-8 (7109xx);
- Минимальное количество внешних компонентов (внутренняя компенсирующая цепь);
- Высокий КПД.

MIK1501BK

Понижающий DC-DC преобразователь с I_{вых} до 5A



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется (Vout=Adj) в процессе внесения в реестр	-	СП MIK1501B, 1501BK (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

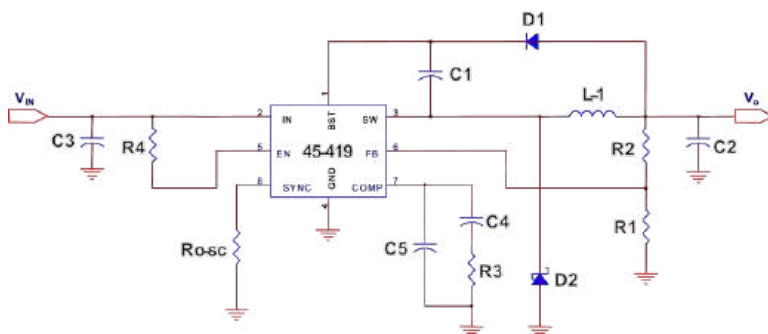
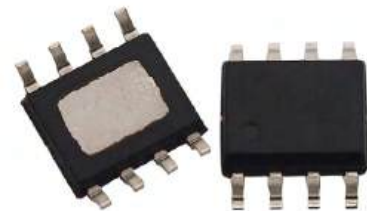
- Диапазон входного напряжения 5.5-40В;
- Выходной ток до 5А (пиковый ток через ключ ~6.9А);
- Версии с регулируемым выходным напряжением и с фиксированным (3.3В, 5В и 12В);
- Рабочая частота 300кГц;
- Вход ON/OFF;
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус TO-263-5 (D2PAK).

Преимущества:

- Функциональный аналог LM2678xx/LM22678xx;
- Минимальное количество внешних компонентов (внутренняя компенсирующая цепь).

MIK45419

Понижающий DC-DC преобразователь с управлением по пиковому току



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361ЕФ3Т (Vout=Adj)	-	АДКБ.431420.558ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Основные характеристики:

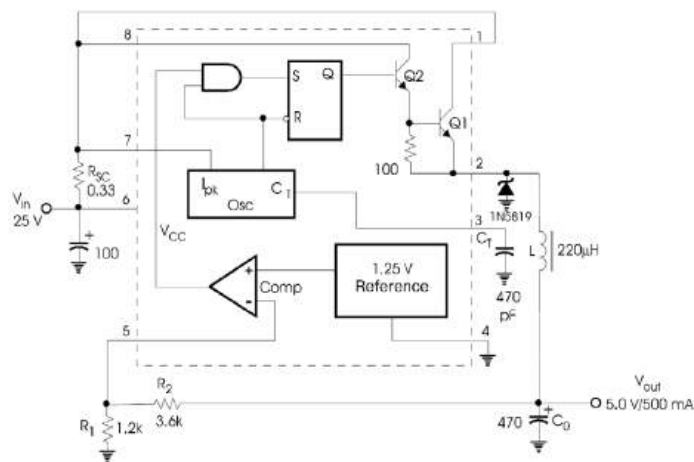
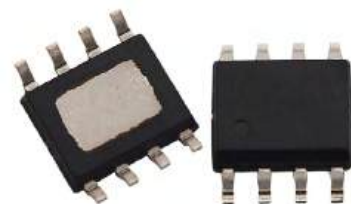
- Диапазон входного напряжения 5 – 30В;
- Выходной ток до 2.5А (пиковый ток через ключ ~4.5А);
- Возможность установки частоты ШИМ в диапазоне 100 – 600кГц;
- Вход EN с прецизионным порогом срабатывания (1.27В);
- Защита от высоковольтных импульсных помех по входу (load dump) до 60В (10мс);
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус 4303.8-C.01 К (ESOP-8) с теплоотводящим контактом.

Преимущества:

- Обратная связь по току позволяет быстро реагировать на изменение нагрузки и использовать керамические SMD конденсаторы меньшей емкости;
- Наличие входа EN позволяет переводить преобразователь в режим ожидания, тем самым снижая энергопотребление устройства.

MIK34063

Понижающий/повышающий DC-DC преобразователь



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K1329ПН1Т (Vout=Adj)	-	АДКБ.431320.612ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Основные характеристики:

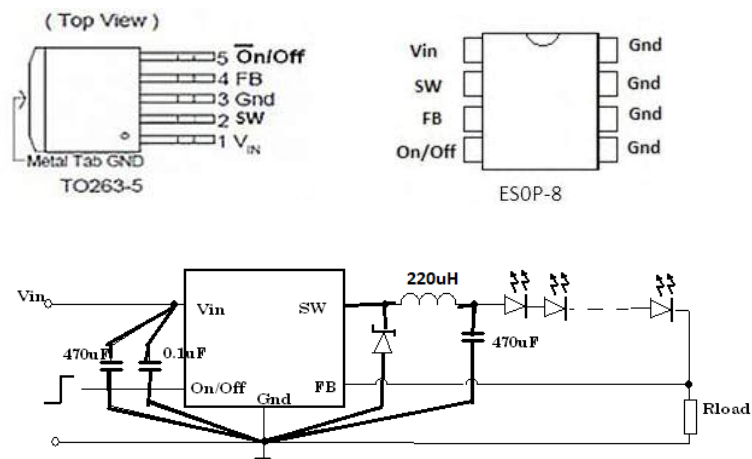
- «Классический» 3х063 преобразователь с опцией исполнения в корпусе с теплоотводящим контактом;
- Диапазон входного напряжения 3 – 40В;
- Пиковый ток через ключ 1.5А;
- Рабочая частота до 100кГц;
- Возможность включения в режиме повышающего и инвертирующего преобразователей;
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус: 4303.8-С.01 К (ESOP-8).

Преимущества:

- Полный аналог преобразователей МС34063/33063;
- Внешний токовый резистор позволяет конфигурировать пиковый ток через дроссель и силовой ключ, а также использовать внешний силовой ключ для увеличения максимального выходного тока.

MIK7015

1A/80V регулируемый, понижающий DC-DC преобразователь



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
MIK7015 (V _{out} =Adj) В процессе внесения в реестр ³	-	СП MIK7015.1HV96K (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

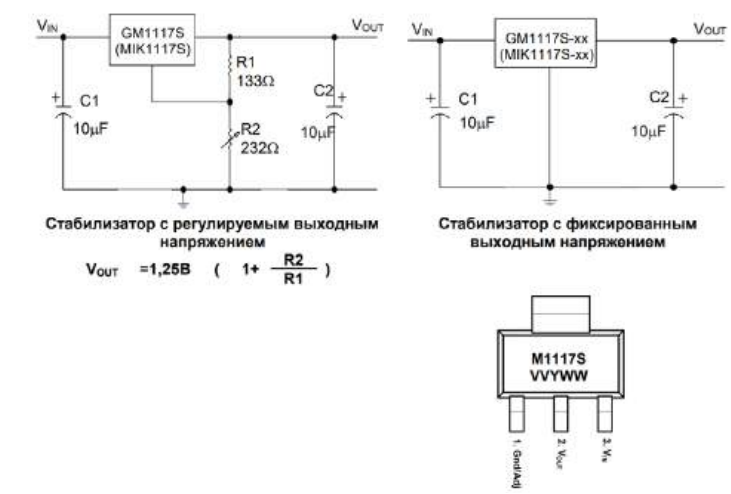
- V_{IN} Max = 80V
- V_{out} = Adj
- V_{FB} = 800mV
- Частота 150кГц
- I_{LED} Max 1A
- Тепловая защита
- Ограничение тока от цикла к циклу
- I_{LOAD} макс. =1A
- В цепочке светодиодов напряжение падает 64В макс. (при требовании T_J<85°C).
- Рабочие температуры: -40...+85°C
- Корпус 4303.8-C.01 K (ESOP-8), TO-263-5

> БИПОЛЯРНЫЕ LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

БИПОЛЯРНЫЕ LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

MIK1117S

Линейный стабилизатор популярной серии 1117



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EH1T	MIK1117S-1.5, серия GM1117S (MIK1117S)	АДКБ.431420.518ТУ
K5361EH1AT	MIK1117S-1.8, серия GM1117S (MIK1117S)	
K5361EH1BT	MIK1117S-2.5, серия GM1117S (MIK1117S)	
K5361EH1DT	MIK1117S-3.3, серия GM1117S (MIK1117S)	
K5361EH1ET	MIK1117S-5.0, серия GM1117S (MIK1117S)	
K5361EP1T	MIK1117S-Adj, серия GM1117S (MIK1117S)	

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



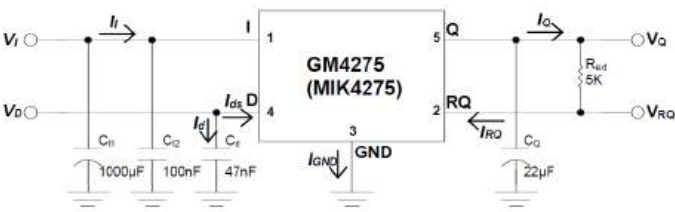
Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

Основные характеристики:

- Входное напряжение до 20В;
- Выходной ток до 1А;
- Падение напряжения вход-выход ~1В (@1А);
- Доступен в версиях с фиксированным и регулируемым выходным напряжением;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°С;
- pin-to-pin совместимость с хх1117 регуляторами мировых производителей;
- Корпус 4342.3-1 К (SOT-223).

MIK4275

LDO регулятор со встроенным генератором сброса для автомобильных применений



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EP1T1 (Vout=5, TO-252-5) В процессе внесения в реестр ¹	GM4275TC5RG	(технические условия в разработке)/ ДВУК.431433.329-001ТУ
K5361EP1T (Vout=5, TO-263-5) В процессе внесения в реестр ¹	GM4275TA5RG	

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

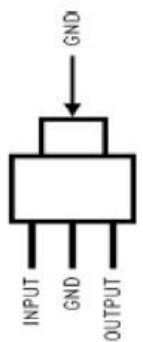
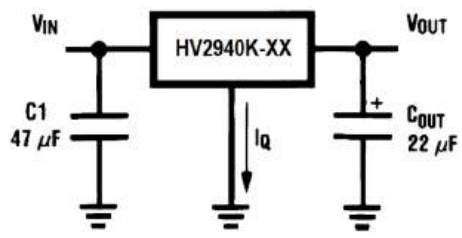
Основные характеристики:

- Фиксированное выходное напряжение 5В@450мА;
- Входное напряжение до 42В;
- Встроенная схема формирования импульса сброса;
- Малое падение напряжения: 250мВ тип;
- Защита от КЗ и обратной полярности;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- pin-to-pin аналог TLE4275 и NCV4275;
- Корпус 4802.5-А К (ГО-252-5) или 4801.5-1 К (ГО-263-5).

БИПОЛЯРНЫЕ LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

МІК2940, МІК2940HV

1А линейный стабилизатор с ультранизким падением напряжения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
К5361ЕНЗГТ (Vout=3.3)	-	АДКБ.431420.613ТУ
К5361ЕНЗДТ (Vout=5)	-	
К5361ЕНЗИТ (Vout=12) В процессе внесения в реестр ³	-	

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)

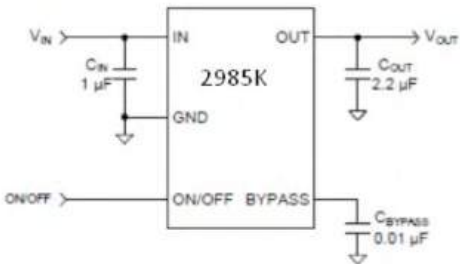
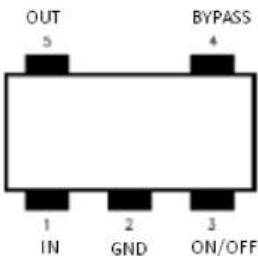


Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 3В – 26В (версия HV – до 60В);
- Ультранизкое падение напряжения вход-выход: 500мВ максимум (400мВ тип.) при максимальном выходном токе 1А (150мВ при 100мА);
- Доступен в версиях с фиксированным напряжением 3.3В, 5.0В, 12В (для версии HV);
- Защита от обратной полярности -20В и превышения входного напряжения до 60В (импульс менее 100мс, скважность не более 1%);
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- pin-to-pin совместимость с LM2940;
- Корпус 4342.3-1 К (SOT-223).

MIK2985

Малозумящий линейный регулятор



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется (Vout=3.3) В процессе внесения в реестр ³	-	СП MIK2985.2985K (технические условия в разработке)
Название уточняется (Vout=5) В процессе внесения в реестр ³	-	СП MIK2985.2985K (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



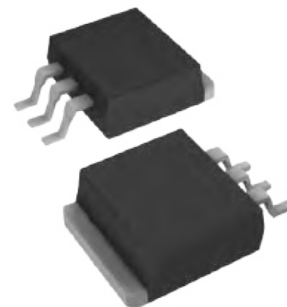
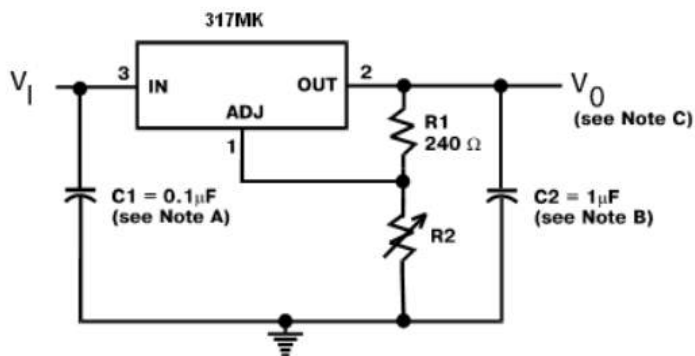
Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 2.5В – 16В;
- Ультранизкое падение напряжения вход-выход: 300мВ максимум при максимальном выходном токе 150мА;
- Доступен в версиях с фиксированным напряжением;
- Стабилен с low-ESR и керамическими конденсаторами, быстрая реакция на импульсное изменение нагрузки;
- наличие вывода bypass для подключение дополнительного фильтрующего конденсатора с целью снижения собственного шума до 30uVrms в полосе 30кГц;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- pin-to-pin совместимость с LP3985/LP2985;
- Корпус 4343.3- 1 K (SOT-23-3).

БИПОЛЯРНЫЕ LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

МІК317

3-ех выводной регулируемый стабилизатор
напряжения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
-	МІК317ТА3RG В процессе внесения в реестр ¹	СП.МІК317.317МК (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)

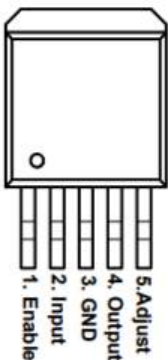
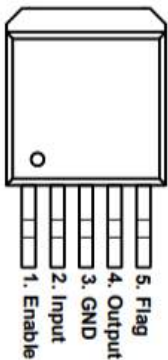


Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 3В - 40В;
- Регулируемое выходное напряжение от 1.2В до 37В;
- Выходной ток до 1.5А;
- Точность стабилизации на входе 0.01 % (тип.);
- Точность стабилизации на выходе 0.1 % (тип.);
- Подавление пульсаций 80дБ;
- Защита от перегрева;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- pin-to-pin совместимость с LM317;
- Корпус TO-263-3.

MIK6615x

1.5A линейный стабилизатор с ультранизким падением напряжения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EP4AT (Vout=3.3) В процессе внесения в реестр ¹	-	
K5361EP4BT (Vout=5) В процессе внесения в реестр ¹	-	АДКБ.431420.608ТУ
K5361EP4T (Vout=Adj) В процессе внесения в реестр ¹	-	

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



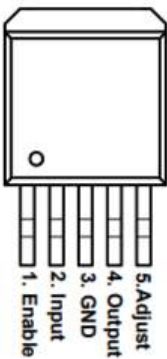
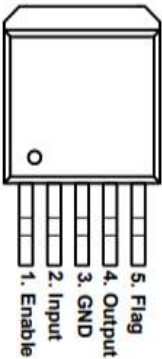
Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 2.3В – 26В;
- Ультранизкое падение напряжения вход-выход: 600мВ максимум (350мВ тип.) при максимальном выходном токе 1.5А (100мВ при 100мА);
- Доступен в версиях с фиксированным (1.5...12В) и регулируемым напряжением;
- Наличие вывода Flag – индикация провала выходного напряжения;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- pin-to-pin совместимость с LD29150/LM29150;
- Корпус 4801.5-1 К (ТО-263-5).

БИПОЛЯРНЫЕ LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

MIK2930x

3А линейный стабилизатор с ультранизким падением напряжения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EP5ГТ В процессе внесения в реестр ¹	-	
K5361EP5ДТ В процессе внесения в реестр ¹	-	АДКБ.431420.609ТУ
K5361EP5Т В процессе внесения в реестр ¹	-	

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)

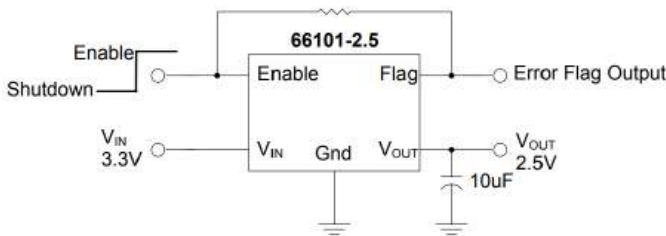


Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 2.3В – 26В;
- Ультранизкое падение напряжения вход-выход: 600мВ максимум (370мВ тип.) при максимальном выходном токе 3А (80мВ при 100мА);
- Доступен в версиях с фиксированным (1.5...12В) и регулируемым напряжением;
- Наличие вывода Flag – индикация провала выходного напряжения;
- pin-to-pin совместимость с LD29300/LM29300;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4801.5-1 К (ТО-263-5).

MIK66100(2)

1А линейный стабилизатор с ультранизким падением напряжения входом EN и выходом монитора выходного напряжения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EH2ГТ ($V_{out}=3.3$, SOT-223)	-	АДКБ.431420.555ТУ
K5361EH2ДТ ($V_{out}=5$, SOT-223) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.555ТУ
Название уточняется ($V_{out}=1.8$, ESOP-8) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.555ТУ
Название уточняется ($V_{out}=2.5$, ESOP-8) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.555ТУ
K5361EP2ГТ1 ($V_{out}=3.3$, ESOP-8)	-	АДКБ.431420.555ТУ
K5361EP2ДТ1 ($V_{out}=5$, ESOP-8) В процессе внесения в реестр ³	-	АДКБ.431420.555ТУ
K5361EP3Т ($V_{out}=Adj$, ESOP-8)	-	АДКБ.431420.555ТУ

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСР](#)



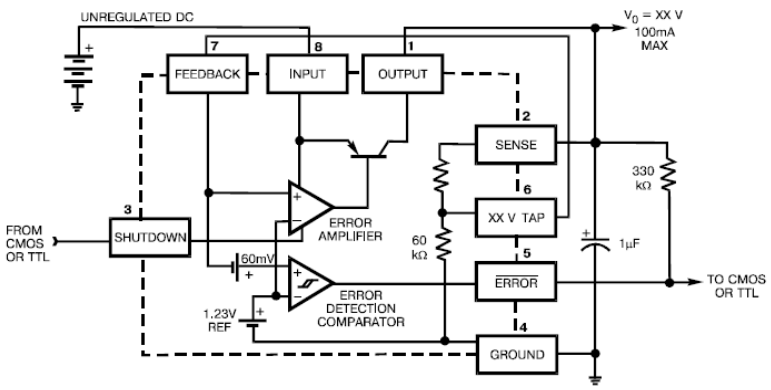
Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 2.25В – 16В;
- Ультранизкое падение напряжения вход-выход: 550мВ максимум 410мВ (тип) при максимальном выходном токе 1А (150мВ при 100мА;
- Доступен в версиях с фиксированным напряжением 1.8В, 2.5В, 3.3В, 5.0В (MIK66100/101) или с регулируемым напряжением (MIK66102) и входом отключения EN (MIK66101/102);
- Наличие вывода FLG – индикация провала выходного напряжения более 5% от номинала (MIK66101);
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпуса MIK66100 – 4342.3-1 К (SOT-223), MIK66101, MIK66102 – 4303.8-C.01 К (ESOP-8).

БИПОЛЯРНЫЕ LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

MIK295x

100mA LDO регулятор $I_q=75\mu\text{A}$



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EP3BT (Vout=3.3)	-	
K5361EP3GT (Vout=5)	-	
Название уточняется (Vout=Adj) В процессе внесения в реестр	-	АДКБ.431420.556ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)

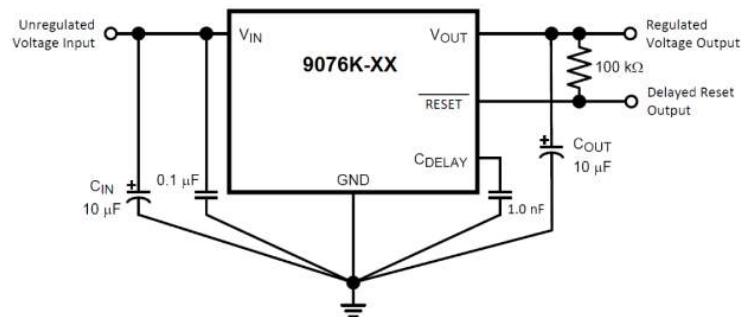


Основные характеристики:

- Входное напряжение до 30В;
- Выходной ток до 100mA;
- Доступен в версиях с фиксированным напряжением 2.85В, 3.0В, 3.3В, 5В и регулируемым 1.24-29В;
- Падение напряжения вход-выход 380mВ при 100mA;
- Выход ~ERROR может быть использован в качестве power-on-reset;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8), pin-to-pin аналог – LM2951.

MIK9076

LDO стабилизатор напряжения с выходным током 150мА, сверхнизким током покоя и задержкой выходного сигнала сброса



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361EH5T (Vout=3.3)	-	АДКБ.431422.715ТУ
K5361EH5AT (Vout=5)	-	АДКБ.431422.715ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



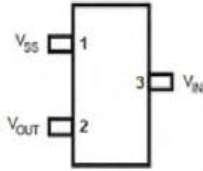
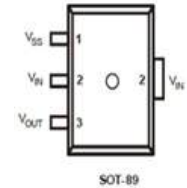
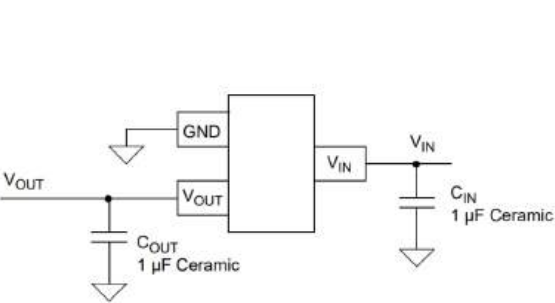
Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения до 40В (пиковые значения +60В/-50В);
- Ток покоя - тип. 25мкА для нагрузки 100мкА;
- Малое падение напряжения - тип. 200 мВ (при нагрузке 150мА);
- Выходной ток до 150мА;
- Доступны версии с выходным напряжением 5.0В или 3.3В;
- Защита от перегрева, защита от переходных процессов на входе;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4303.8-С.01 К (ESOP-8) (аналог LM9076).

➤ КМОП LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

MIK6250, MIK6250H

КМОП линейный стабилизатор с $I_{ss} = 1\mu A$



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5011EH1.8T (Vout=1.8) В процессе внесения в реестр ¹	-	
K5011EH3.3T (Vout=3.3) В процессе внесения в реестр ¹	-	АДКБ.431420.557ТУ
K5011EH5.0T (Vout=5) В процессе внесения в реестр ¹	-	
K5361EH46T (Vout=3.3, SOT-23-3)	-	АДКБ.431420.614ТУ
K5361EH4GT (Vout=5, SOT-23-3)	-	
-	GM6250H-3.3, серия GM6250 (MIK6250) (SOT-89)	ДВУК.431433.334-001ТУ
-	GM6250H-5.0, серия GM6250 (MIK6250) (SOT-89)	

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

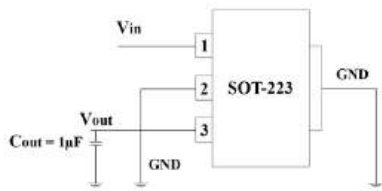
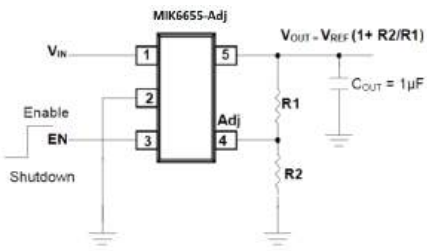
Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 2.7В – 12В (25В для 6250H);
- Самый низкопотребляющий регулятор в линейке Микрон – 1мкА;
- Выходной ток до 250мА;
- Доступен в версиях с фиксированным напряжением 1.8В, 3.3В, 5В;
- Стабилен с low-ESR и керамическими конденсаторами (может работать без выходного конденсатора);
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4343.3-1 К (SOT-23-3), SOT-89, промышленный стандарт по распиновке (MCP1700, AP2138).

КМОП LDO РЕГУЛЯТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ

MIK6655

600mA КМОП стабилизатор с низким собственным потреблением



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется (Vout=1.8) В процессе внесения в реестр ³	-	
Название уточняется (Vout=3.3) В процессе внесения в реестр ³	-	СП.MIK6655.AME8805K (технические условия: в разработке)
Название уточняется (Vout=5) В процессе внесения в реестр ³	-	

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

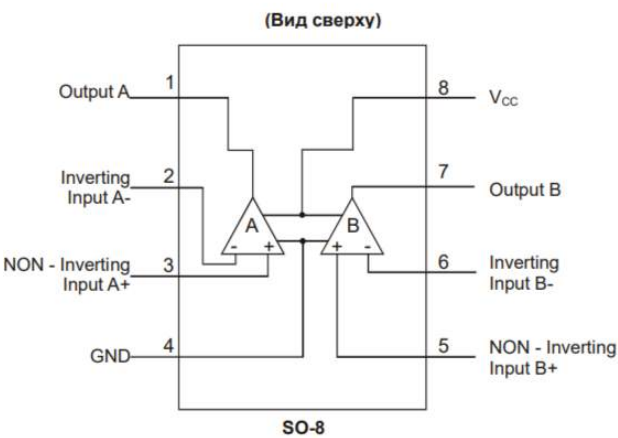
- Диапазон входного напряжения 2.1В - 7В;
- Выходной ток до 600mA;
- Ток собственного потребления ~50мкА (во всем диапазоне тока нагрузки);
- Низкое падение напряжения вход-выход: 600mВ при максимальной нагрузке 600mA;
- Доступен в версиях с фиксированным напряжением: 1.8В, 2.0В, 2.5В, 2.7В, 2.8В, 2.9В, 3.0В, 3.3В, 3.6В, 4.0В, 4.2В и 5.0В, а также с регулируемым выходным напряжением;
- Точность выходного напряжения +/-1.5%;
- Температурная защита и защита от КЗ;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4342.3-1 К (SOT-223).

> ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

MIK358

Сдвоенный ОУ с однополярным напряжением питания (до 40В)



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K740УД1Т (SO-8)	GM358S8RG	АДКБ.431130.529ТУ/ ДВУК.431433.324-003ТУ
K740УД1Т1 (VSSOP-8)	-	АДКБ.431130.529ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



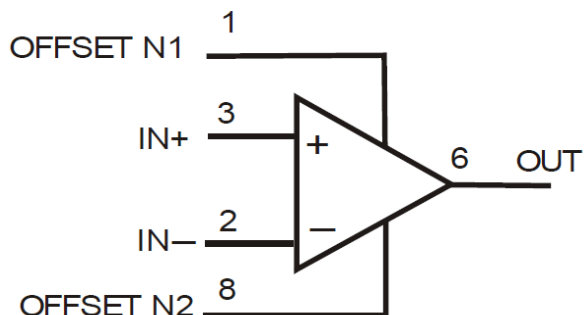
Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

Основные характеристики:

- Диапазон напряжения питания 3 – 40В;
- Типовой ток потребления ~1мА (на 2 усилителя);
- Скорость нарастания 0.7В/мкс;
- Полоса единичного усиления 700кГц;
- Входной ток смещения -20нА типовой;
- Выходной ток КЗ: 50мА;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°С;
- Аналог LM358/2904;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8) – K740УД1Т, GM358S8RG, 4344.8-1К (VSSOP-8) – K740УД1Т1.

МІКОР07

Прецизионный операционный усилитель



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
К740УД2Т	-	АДКБ.431130.538ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



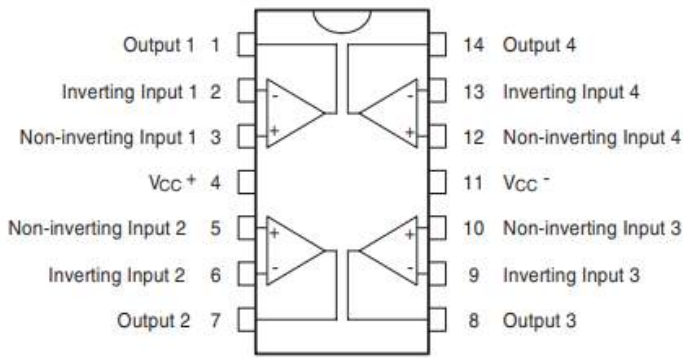
Основные характеристики:

- Диапазон напряжения питания $\pm 18\text{В}$;
- Максимальный ток потребления $\sim 2.5\text{мА}$ (на 2 усилителя);
- Скорость нарастания 0.3В/мкс ;
- Полоса единичного усиления 600кГц ;
- Входной ток смещения -1.2нА типовой;
- Рабочий диапазон температур: $-40 \dots +85^\circ\text{C}$;
- Аналог ОР07;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

МІК324

Счетверенный ОУ



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
-	МІК324S14RG В процессе внесения в реестр ¹	СП МІК324.324М2К (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

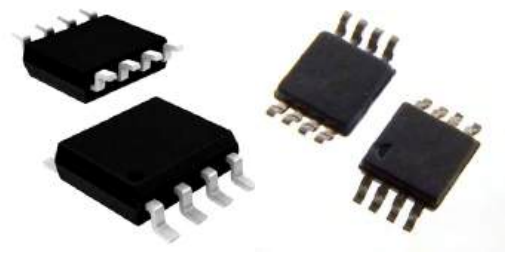
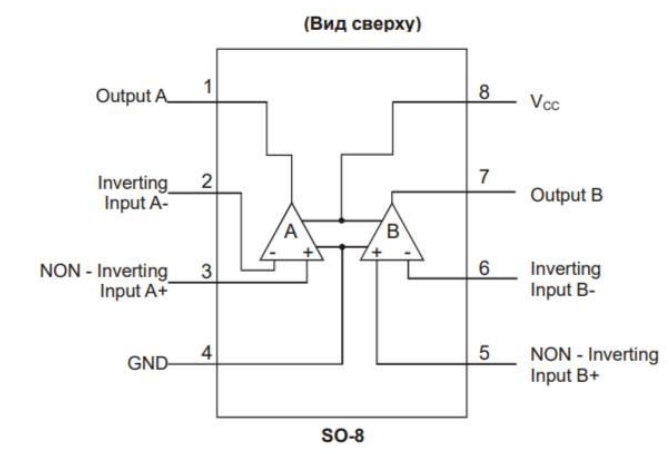
- Напряжение питания: 36В или +/- 18В;
- Типовой ток потребления: 1.1мА;
- Скорость нарастания: 0.5В/мкс;
- Полоса единичного усиления (полоса пропускания): 1.2МГц;
- Входной ток смещения: 20нА;
- Выходной ток КЗ: +/- 40мА;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Аналог LM324/2902;
- Корпус SO-14.

> КОМПАРАТОРЫ

КОМПАРАТОРЫ

MIK393

Маломощный сдвоенный компаратор
с открытым коллектором



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K597CA1T (SO-8)	GM393S8RG	АДКБ.431350.530ТУ/ ДВУК.431433.324-004ТУ
K597CA1T1 (VSSOP-8)	-	АДКБ.431350.530ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



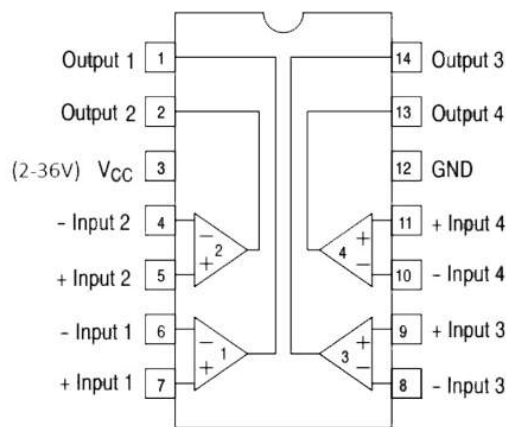
Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

Основные характеристики:

- Диапазон напряжения питания 2 – 36В ($\pm 1 - \pm 18$ В);
- Типовой ток потребления ~ 0.5 мА;
- Входной ток смещения 25нА тип;
- Время задержки 1.3мкс (макс) перепад входного напряжения 100мВ);
- Выходное напряжение совместимо с ТТЛ, МОП и КМОП логикой;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Аналог LM393/2903;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8) – K597CA1T, GM393S8RG, 4344.8-1K (VSSOP-8) – K597CA1T1.

МІК339

Счетверенный дифференциальный компаратор



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
-	МІК339S14RG В процессе внесения в реестр ¹	СП.МІК339.339МК (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



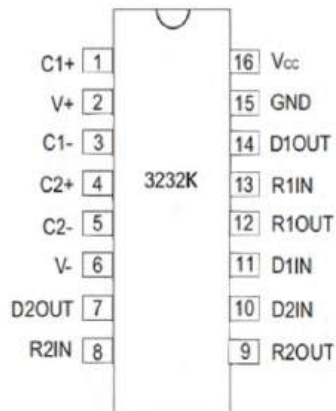
Основные характеристики:

- Диапазон напряжения питания 2 – 36В (или $\pm 1 - \pm 18В$);
- Типовой ток потребления $\sim 0.8mA$;
- Входной ток смещения 25нА тип.;
- Время задержки 1.3мкс (макс) перепад входного напряжения 100мВ);
- Выходное напряжение совместимо с ТТА, МОП и КМОП логикой;
- Рабочий диапазон температур: $-40...+85^{\circ}C$;
- Аналог LM339/2901;
- Корпус SO-14.

> ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

MIK3232

Трансивер RS-232 3B-5.5B



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5659ИН1Т	-	АДКБ.431230.610ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Основные характеристики:

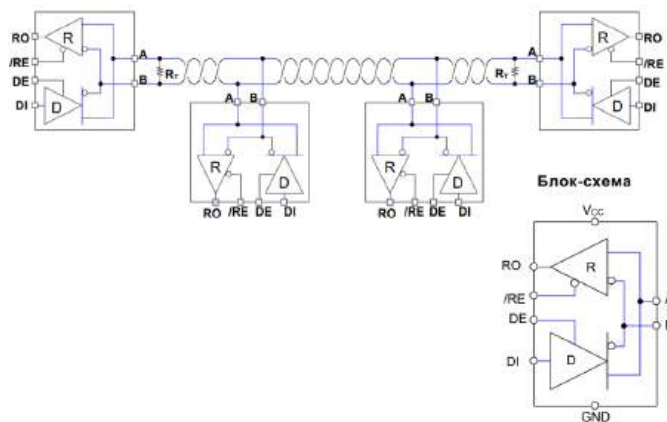
- Напряжение питания +3.0В - +5.5В;
- 2 драйвера, 2 приемника;
- Скорость до 250кбит/с;
- ESD $\pm 15\text{kV}$ HBM;
- Встроенный charge-pump преобразователь;
- Рабочий диапазон температур: $-40 \dots +85^\circ\text{C}$;
- pin-to-pin аналог MAX3232;
- Корпус 4307.16-D K (SOP-16).

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

MIK485

Полудуплексный трансивер RS-485

Типовая схема применения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361BB2T (256 узлов)	GM485	АДКБ.431290.515ТУ/ ДВУК.431433.324-002ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

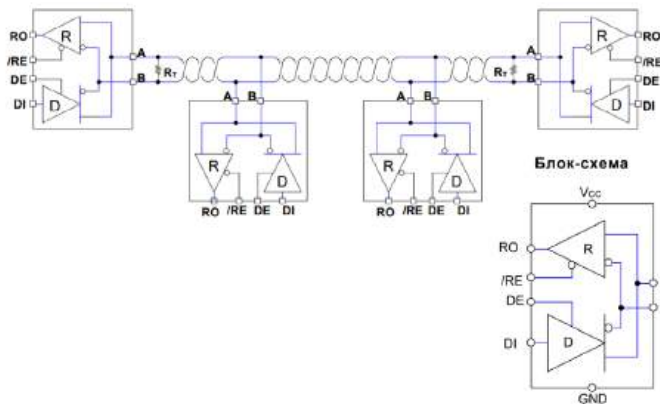
Основные характеристики:

- Напряжение питания +5В;
- Скорость до 5Мбит/с;
- ESD ±15кВ HBM;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

MIK3485

Полудуплексный трансивер RS-485 3.3В

Типовая схема применения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5361B81T	GM3485	АДКБ.431290.514ТУ/ ДВУК.431433.324-001ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

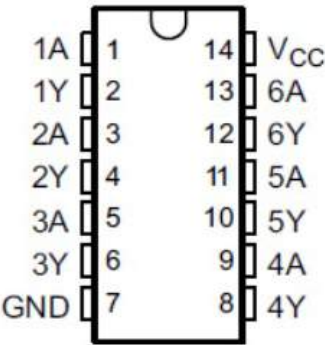
Основные характеристики:

- Напряжение питания +3.3В;
- Совместим с 5В логикой;
- Скорость до 10Мбит/с;
- ESD ±15кВ HBM;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

> ЛОГИЧЕСКИЕ ИС

MIK74HC04

Шесть логических элементов «НЕ»



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
-	MIK74HC04S14RG В процессе внесения в реестр	СП MIK74HC04.74HC04K (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)

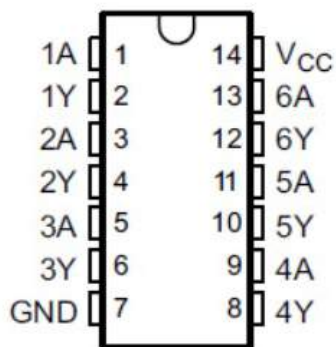


Основные характеристики:

- Широкий диапазон рабочего напряжения от 2В до 6В;
- Выходы могут управлять нагрузкой до 10 LSTTL схем;
- Задержка распространения: $t_{pd} = 7 \text{ нс}$;
- Входной ток: не более 1 мкА;
- Ток потребления (статический): максимум 20 мкА;
- Выходной ток: максимум 25 мА;
- Рабочий диапазон температур: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$;
- Аналог 74HC04;
- Корпус SO-14.

МІК74НС14

Инвертирующий триггер Шмитта



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
-	МІК74НС14 В процессе внесения в реестр	СП МІК74НС14.74НС14К (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



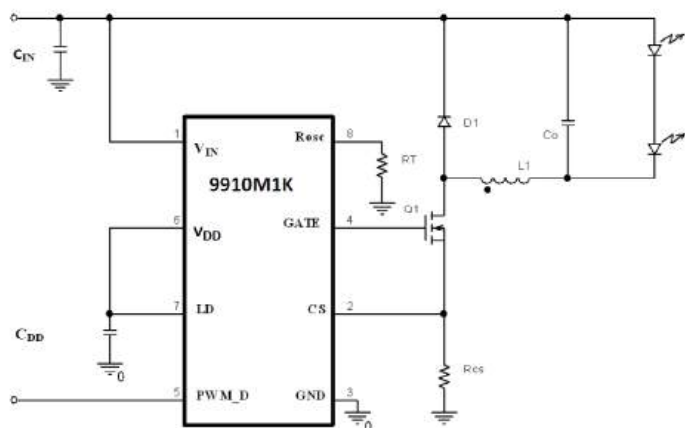
Основные характеристики:

- Широкий диапазон рабочего напряжения от 2В до 6В;
- Выходы могут управлять нагрузкой до 10 LSTTL схем;
- Задержка распространения: $t_{pd} = 11$ нс;
- Максимальный ток через каждый выходной выход: 25 мА;
- Типичное время переключения: 6–13 нс;
- Рабочий диапазон температур: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$;
- Аналог 74НС14;
- Корпус SO-14.

> АС-DC LED ДРАЙВЕР

MIK9910

Светодиодный драйвер $U_{вх} = 10 - 600V$



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K1483XB1T	-	АДКБ.431290.539ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



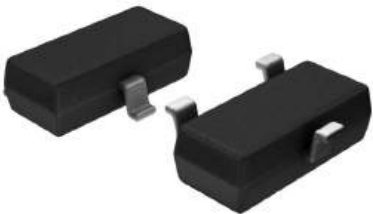
Основные характеристики:

- Диапазон входного напряжения 10-600В;
- Высокий КПД >90%;
- Возможность линейного и ШИМ регулирования;
- Выходной ток определяется выбранными внешними компонентами (MOSFET/диодом, датчиком тока и пр.);
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Аналог HV9910B с увеличенным до 600В напряжением на входе;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

➤ **КОНТРОЛЛЕРЫ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ**

МІК431А/АR, МІК432

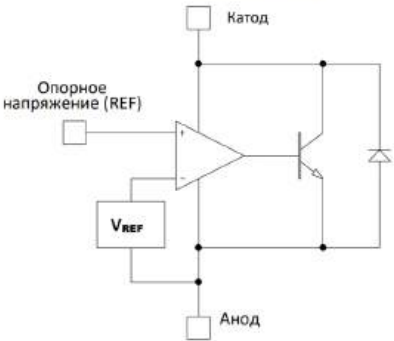
Трехвыводной источник опорного напряжения



Логическое обозначение



Блок схема



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K5011EP2T (точность 0.5%, инверсный)	-	АДКБ.431420.607ТУ
K5011EP2AT (точность 1%, инверсный)	-	АДКБ.431420.607ТУ
K5011EP1T (точность 0.5%, прямой)	GM431SAST23RG	АДКБ.431420.607ТУ/ ДВУК.431433.327-002ТУ
K5011EP1AT (точность 1%, прямой)	-	АДКБ.431420.607ТУ
K5361EP2T	GM432 (МІК432)	АДКБ.431420.519ТУ/ ДВУК.431433.327-001ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



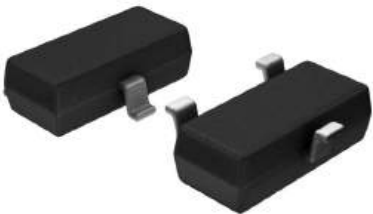
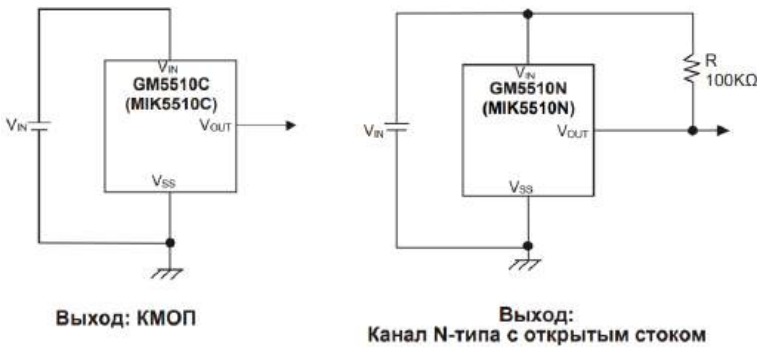
Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

Основные характеристики:

- Выходное напряжение: 2.5-36В (МІК431); 1.24-16В (МІК432);
- Опорное напряжение 2.5В (МІК431); 1.24В (МІК432);
- Точность 0.5% (МІК431SA, МІК432); 1% (МІК431SB);
- Максимальный ток катода 100мА;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°С;
- Аналог TL431/432;
- Корпус 4343.3-1 К (SOT-23-3).

MIK5510C/N

КМОП датчик напряжения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
K1483ДН2.7А1Т ($V_{in}=2.7$) В процессе внесения в реестр ^{3*}	GM5510C-2.7, серия GM5510C-xx	АДКБ.431340.611ТУ, ДВУК.431433.327-003ТУ
K1483ДН2.9А1Т ($V_{in}=2.9$) В процессе внесения в реестр ^{3*}	GM5510C-2.9, серия GM5510C-xx	АДКБ.431340.611ТУ, ДВУК.431433.327-003ТУ
K1483ДН3.3А1Т ($V_{in}=3.3$) В процессе внесения в реестр ^{3*}	GM5510C-3.3, серия GM5510C-xx	АДКБ.431340.611ТУ, ДВУК.431433.327-003ТУ

В серии,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



[Найти в реестре ГИСП](#)



Применение микросхем именно 1-го уровня обеспечивает максимальное количество баллов при оценке локализации продукции.

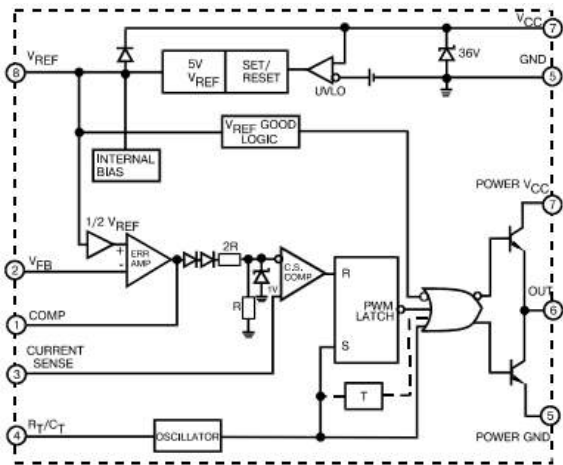
Основные характеристики:

- Диапазон датчика напряжения: 1,6 В до 6,0 В с шагом 0,1 В;
- Диапазон рабочего напряжения: 0,7 до 10,0 В;
- Высокая точность: $\pm 2 \%$;
- Конфигурация выхода: КМОП или канал N-типа с открытым стоком;
- Рабочий диапазон температур: $-40 \dots +85^\circ\text{C}$;
- Корпус 4343.3-1 К (SOT-23-3).

> ШИМ КОНТРОЛЛЕРЫ

MIK3842

ШИМ-контроллер с регулированием по току



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется в процессе внесения в реестр ³	-	СП.МІК384х.КА3842ВW2К (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

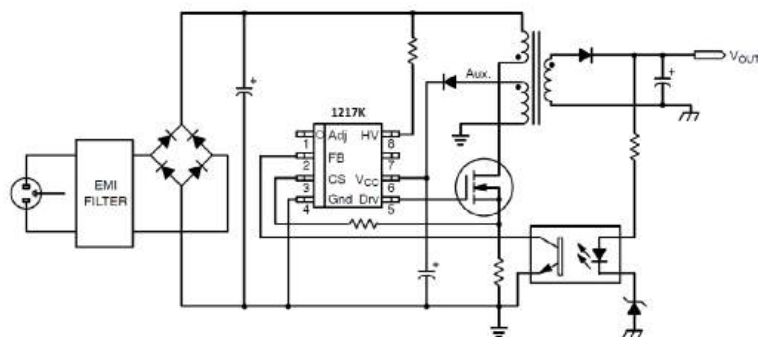
- Рабочее напряжение: от 10 В до 30 В;
- Выходной ток: +/- 1А;
- Рабочая частота: 500кГц;
- Максимальный рабочий цикл: 100%;
- Рабочий ток питания: 25 мА;
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

Преимущества:

- Современная альтернатива UC384х;
- Встроенный триггер Шмидта (UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16В, и выключает, если напряжение питания станет ниже 10В;
- Защита от перенапряжения: если напряжение питания превысит 34 В, микросхема отключится.

MIK1217

Контроллер для AC-DC источников питания



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется в процессе внесения в реестр ³	-	СП.МІК1217.1217К (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

- Встроенная схема высоковольтного запуска 500В;
- Драйвер внешнего МОП-транзистора +/-500мА;
- Фиксированная рабочая частота 100кГц;
- Управление по пиковому току;
- Наличие регулируемого режима пропуска управляющих импульсов;
- Защита от КЗ (с автоматическим перезапуском), защита от перегрева и превышения напряжения по входу;
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C.
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

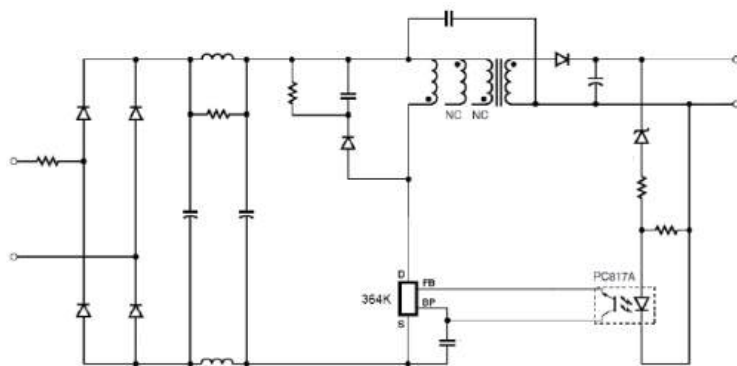
Преимущества:

- Функциональный аналог NCP1217;
- Современная альтернатива UC384х;
- Достаточно мощный драйвер для реализации источников питания мощностью до 100Вт.

➤ МИКРОСХЕМЫ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

МІК364

Контроллер для AC-DC источников питания
со встроенным ключом



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется в процессе внесения в реестр ³	-	СП.МІК364.364К (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



Основные характеристики:

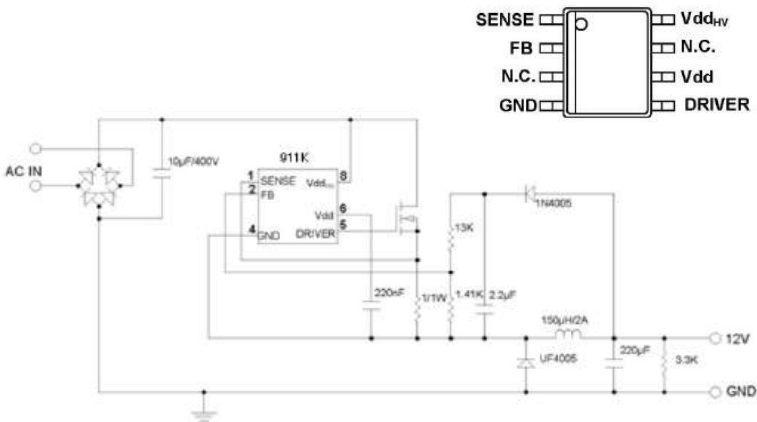
- Встроенный МОП-транзистор 700В;
- Фиксированная рабочая частота 132кГц;
- Встроенная схема запуска и высоковольтного питания;
- Защита от перегрева и КЗ;
- Выходная мощность ИП 4-6Вт при входном напряжении (85-265VAC);
- Рабочий диапазон температур: -40°C...+85°C;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

Преимущества:

- Широкий выбор стандартных трансформаторов;
- Отсутствие необходимости дополнительной обмотки трансформатора;
- Минимальное количество внешних компонентов;
- Функциональный аналог LNK364 (МІК364 имеет более низкое $R_{ds(on)}$ встроенного транзистора $\sim 11\Omega$ vs 24Ω).

MIK911

Контроллер высоковольтного импульсного стабилизатора напряжения



Название ИМС 1-го уровня локализации	Название ИМС 2-го уровня локализации	Технические условия (ТУ)/ спецификации на кристалл (СП)
Название уточняется в процессе внесения в реестр ³	-	СП.МІК911.911К (технические условия в разработке)

В освоении,
ПП РФ №719.

[Заказать на сайте](#)



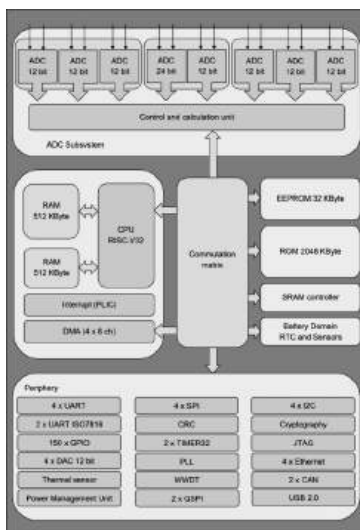
Основные характеристики:

- Работа от источника с напряжением переменного тока 85~265 VAC;
- Частота: 90 кГц;
- Не требуется внешний источник питания постоянного тока;
- Напряжение на выводе FB (VFB) 1.0В;
- Коэффициент заполнения: 0% до 5% – ЧИМ, 5% до 85% – ШИМ;
- Встроенная схема ограничения тока - задается внешним резистором;
- Функция плавного запуска (soft start);
- Встроенный высоковольтный генератор;
- Рабочий диапазон температур: -40...+85°C;
- Корпус 4303.8-С К (SO-8).

**> НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РАЗРАБОТКИ
(НА ЭТАПЕ ОКР)**

K1948BG1T

Микроконтроллер MIK32-2



Серия: 2028 год

Зарубежные аналоги:
STM32H743 (STM)



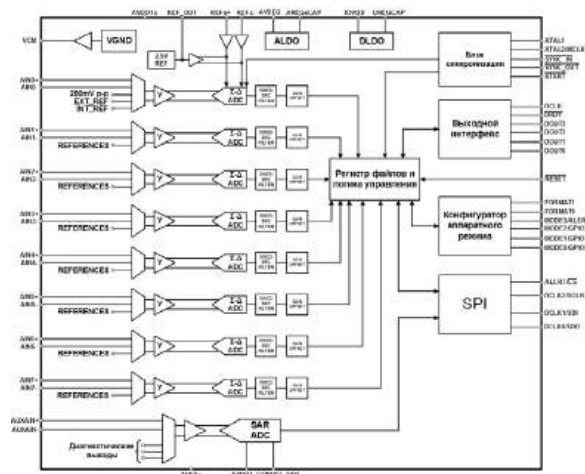
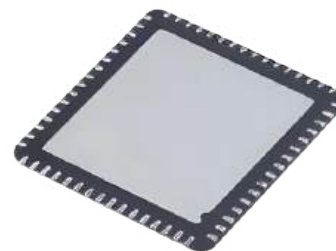
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Ядро – RISC-V 32-бита;
- Частота процессора – не менее 150 МГц;
- Объем ПЗУ – не менее 2048 кБайт;
- Объем ОЗУ – не менее 1024 кБайт;
- Объем ЭППЗУ – не менее 32 кБайт;
- Контроллер DMA – 4 x 8 каналов;
- Интерфейсы: QSPI – 2; SPI – 4; I2C – 4;
- UART – 4 (с поддержкой ISO7816 - 2);
- CAN – 2; USB 2.0 – 1; Ethernet – 4; JTAC;
- GPIO (устойч. к вх. напр. 5 В) – не менее 64;
- АЦП – 12-бит, 8 каналов, 1 МГц;
- ЦАП – 12-бит, 4 канала, 1 МГц;
- Таймер общего назначения (32-разр.) – 2;
- Сторожевой таймер (WWDI) – 1;
- ШИМ-контроллер – 2;
- Часы реального времени – 1;
- Датчик температуры;
- Идентификатор (серийный номер кристалла);
- Поддержка режимов пониженного энергопотребления (отключение периферии, отключение RAM, гибернация, пробуждение по прерываниям);
- Поддержка криптографической защиты данных ГОСТ Р 34.12-2015, AES 128/256) – опционно;
- Напряжение питания – 3,3 В ± 10%.

К5108ПВ4У

Восьмиканальный 16-разрядный сигма-дельта АЦП



Серия: 2028 год

Зарубежные аналоги:
ADS131E08 / AD7779 (TI/ADI)



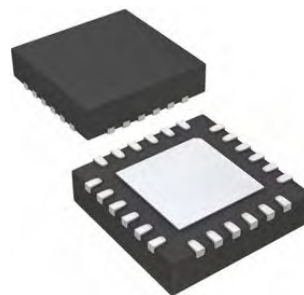
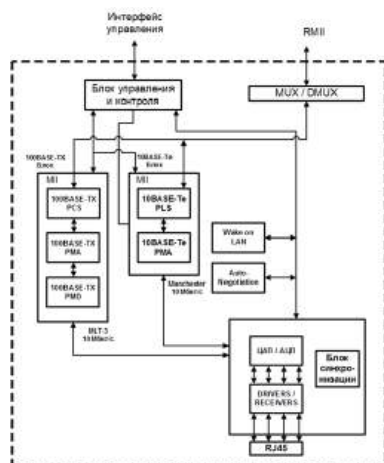
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Разрядность – не менее 16 бит;
- Частота дискретизации – не менее 64 KSPS;
- Количество каналов – 8;
- Встроенный ИОН; возможность использования внешнего ИОН;
- Программируемый коэффициент усиления;
- Синхронная выборка по каналам;
- Режим пониженного энергопотребления;
- Дифференциальный/униполярный вход;
- Полоса пропускания аналогового тракта – до 100 кГц по уровню -3дБ;
- Напряжение питания номинальное – $3,3 \text{ В} \pm 10\%$.

K5361BB3Y

Четырехканальный трансивер Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX с интерфейсом RMII/MII



Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
KSZ8081 (Microchip)

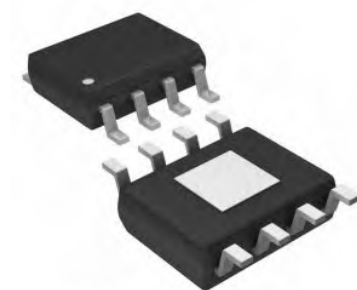
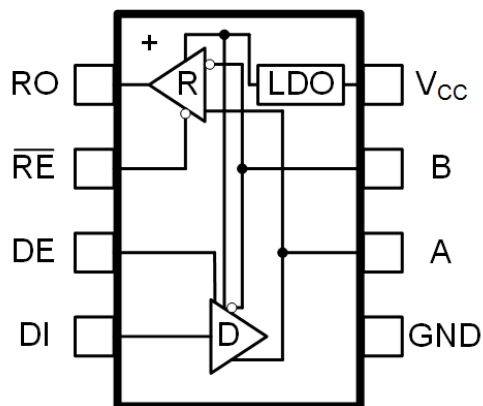
Основные характеристики:

- Количество каналов – 4;
- Напряжение питания – $3,3\text{ В} \pm 10\%$;
- Поддержка интерфейса RMII;
- Выводы индикации статуса и активности;
- Встроенное терминирование диф.пар;
- Режимы пониженного энергопотребления;
- Автоматический выбор режима (дуплекс/полудуплекс) и скорости обмена (10/100 Мбит/с);
- Программируемый вывод прерываний;
- Программируемый режим самодиагностики.



К1533ЕП1Т

Драйвер интерфейсов RS485/RS422



Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
MAX13412 (Maxim)



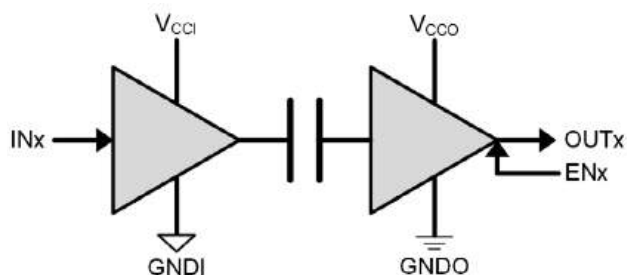
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Количество каналов – не менее 1;
- Встроенный LDO;
- Пропускная способность – до 16 Мбит/с;
- Дифференциальный выход 5В, 20 мА;
- Поддержка режима пониженного энергопотребления;
- Напряжение питания - +6 В...+28 В $\pm 10\%$.

K1661ИП1Т

Четырехканальный цифровой изолятор



Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
ISO7341 (TI)



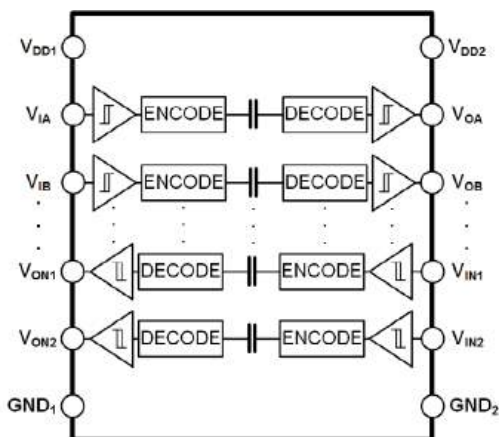
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Количество каналов – не менее 4;
- Тип изоляции – емкостная;
- Максимальная пропускная способность – не менее 25 Мбит/с;
- Напряжение изоляции – не менее 2,5 кВ;
- Функционирование с цифровыми сигналами с номинальными уровнями напряжений 3,3 В и 5,0 В;
- Номинальное напряжение питания – от 3,3 В до 5,0 В.

К1661ИП2Т

Шестиканальный цифровой изолятор с повышенной пропускной способностью



Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
ADuM262 (ADI)



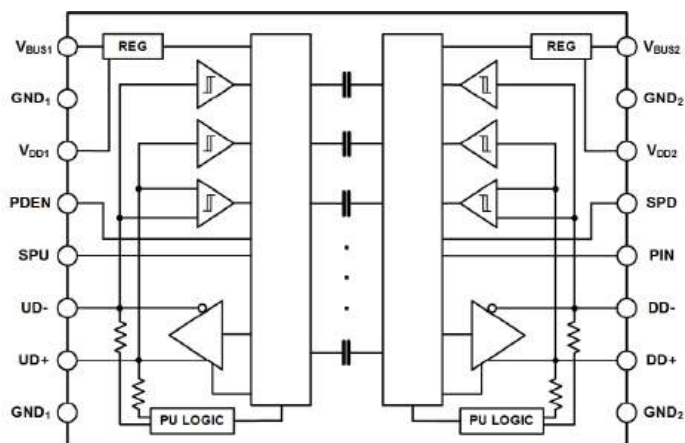
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Количество каналов – не менее 6;
- Тип изоляции – емкостная;
- Максимальная пропускная способность – не менее 150 Мбит/с;
- Функционирование с цифровыми сигналами с номинальными уровнями напряжений 3,3 В и 5,0 В;
- Номинальное напряжение питания – от 3,3 до 5В;
- Напряжение изоляции – не менее 2,5 кВ.

К1661ИПЗТ

Цифровой изолятор USB



Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
ADuM3160 (ADI)



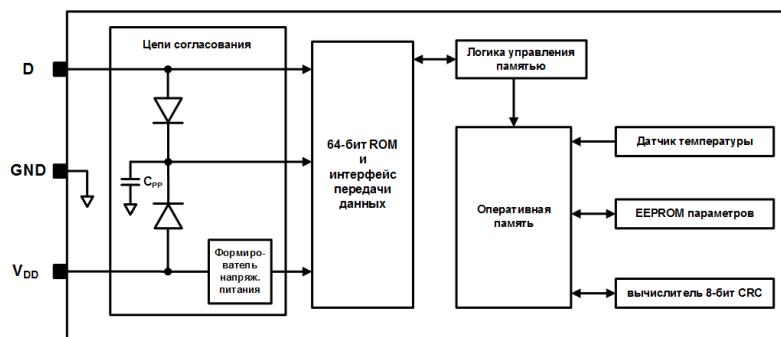
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Поддержка интерфейса USB 2.0;
- Количество каналов USB – не менее 1;
- Возможность двунаправленной передачи по интерфейсу USB;
- Защита от КЗ;
- Поддержка режимов Low и Full speed (1.5 и 12 Мбит/с);
- Номинальное напряжение питания – 3,3 В;
- Напряжение изоляции – не менее 2,5 кВ.

K5019CT1T

Цифровой датчик температуры



Серия: 2028 год

Зарубежные аналоги:
DS18S20Z (Maxim/Dallas)



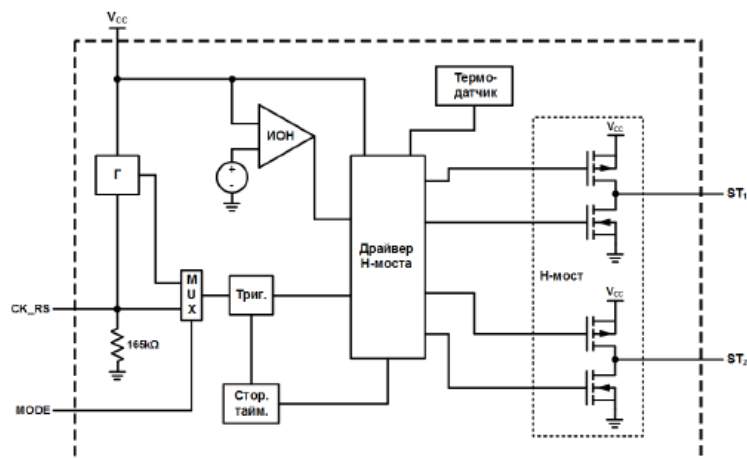
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Диапазон измеряемых температур
 - от не более минус 55°C до не менее +125°C;
- Погрешность измерения:
 - не хуже $\pm 0.5^\circ\text{C}$ в диапазоне измеряемых температур от не более минус 10°C до не менее +85°C
 - не хуже $\pm 2.0^\circ\text{C}$ в диапазоне измеряемых температур от не более минус 55°C до не менее +125°C;
- 9-битное представление измеряемой температуры;
- Однопроводной последовательный цифровой интерфейс;
- Chip ID (уникальный 64-х битный код);
- Возможность задания оповещений о выходе измеряемой температуры за пределы установленного пользователем диапазона;
- Возможность сохранения задаваемых параметров во встроенной энергонезависимой памяти;
- Номинальное напряжение питания – от 3,0 В до 5,0 В.

K1533EP2T

Драйвер изолированных источников питания



Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
MAX256ASA (Maxim/Dallas)



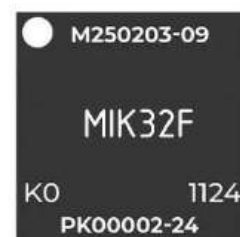
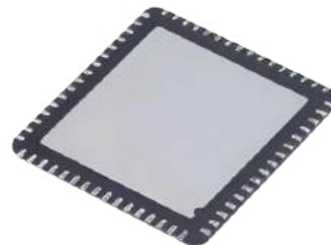
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Максимальная выходная мощность – не менее 3W;
- Выходные каскады - H-мост MOSFET;
- Обеспечение симметрии формируемых выходных импульсов (меандр, 50%) для отсутствия постоянной составляющей в первичной обмотке трансформатора; наличие встроенной защиты от перегрева и перенапряжений;
- Встроенная защита от перегрева и пониженного напряжения;
- Наличие режима энергосбережения;
- Возможность внешнего тактирования с WDT;
- Встроенный генератор с возможностью задания частоты при помощи внешнего резистора;
- Номинальное напряжение питания – 3,3 В или 5,0 В.

Микроконтроллер MIK32F

развитие линейки MIK32 Амур (K1948BK015)



Серия: 2028 год

Аналоги:
НИИЭТ K1921BG015, Baikal-U (BE-U1000)



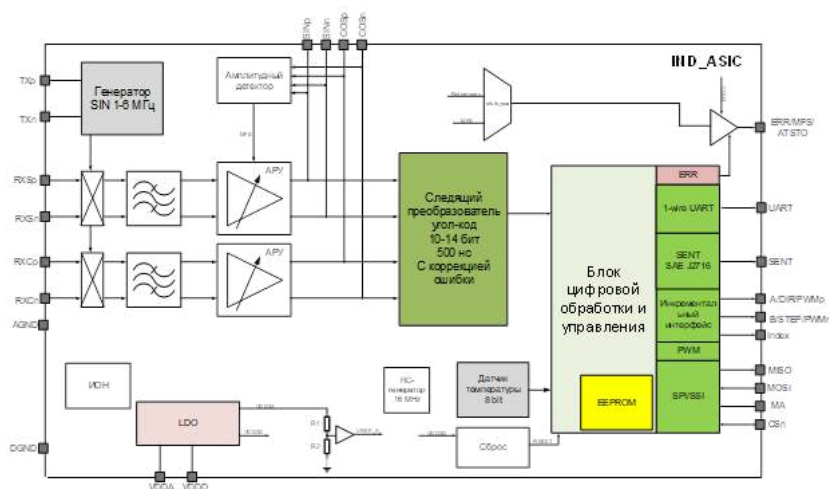
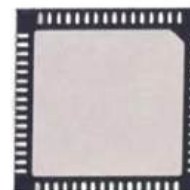
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Ядро: SCR1 RISC-V;
- Частота, МГц: 72;
- Объем памяти программ: 16 Мбит Flash;
- Объем ОЗУ, кб: 96 (64k+32k);
- GPIO: 80;
- USART: 4;
- USB-D: 1;
- SPI/I2C: 4/4;
- Таймер 16 бит: 3;
- Таймер 32 бит: 4;
- Таймер для моторов 16 бит: ETimer32;
- АЦП, 10-12 бит: 8;
- ЦАП, 10-12 бит: 1;
- Шифрование: AES128 + ГОСТ;
- Диапазон рабочих температур: -45 ... +85 °C;
- Корпус, кол-во выводов: 40-80 (QFN64-QFN104).

MIK2200

Микросхема бесконтактного индуктивного датчика положения на основе вихревых токов



Серия: 2028 год

Зарубежные аналоги:
AS5715 (AMS), LX34070, IPS2200



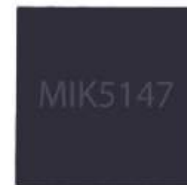
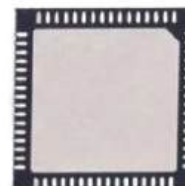
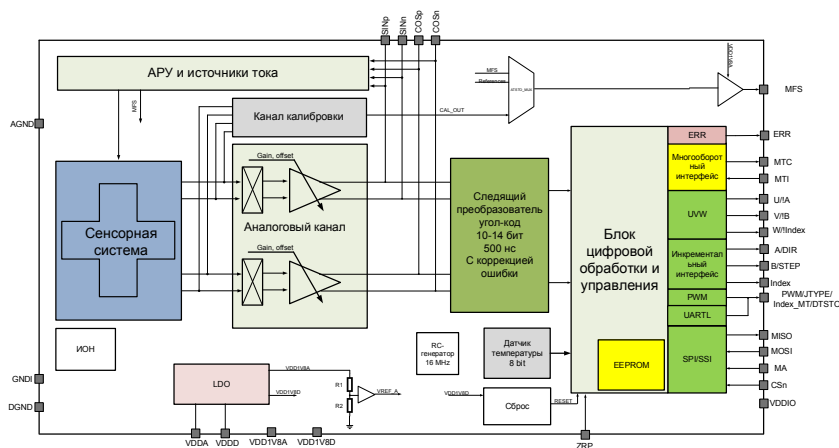
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Частота LC генератора: От 1 до 6 МГц
- Разрешение: 10-14 бит (до 16384 отсчетов на оборот, 2.5°), программируемое.
- Скорость вращения:
 - 14 бит / 30 000 rpm;
 - 13 бит / 60 000 rpm;
 - 12 бит / 120 000 rpm;
 - 11 бит / 240 000 rpm;
 - 10 бит / 480 000 rpm.
- Общая ошибка преобразования: $\pm 0.35^\circ$
- Поддерживаемые интерфейсы: SPI/SSI (Максимальная частота 4 МГц);
Инкрементальный интерфейс A/B/Z и STEP/DIR;
Синусно-косинусный дифференциальный;
Однопроводный UART;
Однопроводной SENT;
- Интерфейс программирования: SPI; UART;
- Напряжение питания: $5.0 \pm 10\%$ В;
- Ток потребления: не более 30 мА (без нагрузки);
- Напряжение цифровых входов-выходов: 3.3В (5В толерантные);
- Диапазон рабочих температур: От -40 до +125 °C;
- Дополнительные возможности: Автоматическая регулировка усиления;
Встроенный датчик температуры;
- Аналоги: AS5715 (AMS), LX34070 (Microchip), IPS2200 (Renesas);
- Корпус: QFN-64, 8x8 мм, шаг 0.4мм.

MIK5147

Микросхема абсолютного On-Axis магнитного датчика
углового положения PSA-13M



Серия: 2028 год

Зарубежные аналоги:
iC-MHM (IC Haus), AS5147 (AMS),
AEAT-8811-Q204, (Broadcom)



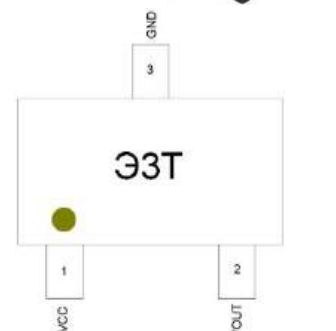
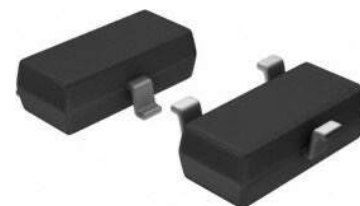
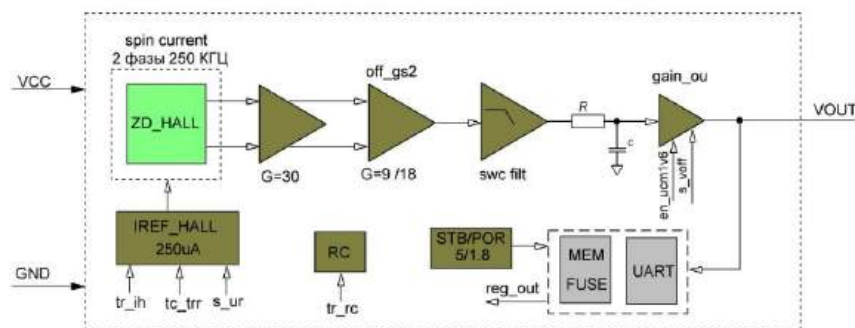
1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Разрешение: 10-14 бит (до 16384 отсчетов на оборот), программируемое.
- Скорость вращения:
 - 14 бит / 30 000 rpm;
 - 13 бит / 60 000 rpm;
 - 12 бит / 120 000 rpm;
 - 11 бит / 240 000 rpm;
 - 10 бит / 480 000 rpm;
- Общая ошибка преобразования: $\pm 0.35\%$;
- Поддерживаемые интерфейсы: SPI/SSI (Максимальная частота – 4 МГц);
- Инкрементальный интерфейс A/B/Z и STEP/DIR;
- Синусно-косинусный дифференциальный;
- Однопроводный UART;
- Трехфазный UVW выход с программируемым количеством полюсов (эмуляция датчиков Холла);
- Выход ШИМ с программируемой несущей частотой и диагностическими уровнями;
- Интерфейс программирования SPI;
- Напряжение питания: $5.0 \pm 1(\%)$ В;
- Ток потребления: не более 33 мА (без нагрузки);
- Напряжение цифровых входов-выходов: 3.3В/5В (определяется напряжением на входе VDDIO);
- Диапазон рабочих температур: От -40 до +125 °C;
- Дополнительные возможности: Автоматическая регулировка усиления; Встроенный датчик температуры; Выход сигнала аналогичный с программируемым состоянием; Многооборотный интерфейс;
- Диапазон индукции магнитного поля: От 20 до 80 мТ;
- Допустимое постоянное магнитное смещение: ± 10 мТ;
- Рекомендованный магнит: NdFeB/SmCo D=5-8 мм, h=2-4 мм;
- Расстояние от поверхности магнита до микросхемы: От 0.5 до 1.5 мм;
- Корпус: QFN-64, 8x8 мм, шаг 0.4мм.

K1949ЧЭЗ

Микросхема 1 осевого датчика магнитного поля
с аналоговым выходом (ИДМ ПЛЮС)



Обозначение выводов микросхемы.
вид сверху, корпус SOT-23-3 (2.9мм* 2.9мм)

Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
CN1612xx01300



1 уровень локализации

Краткое описание

- Микросхема является программируемым линейным датчиком магнитного поля, на основе эффекта Холла.
- Выходной сигнал микросхемы ратнометрический (чувствительность изменяется кратно изменению напряжения питания, напряжение на выходе, при отсутствии поля = $VCC/2$).
- Микросхема имеет однократно программируемую память, для хранения настроек всего тракта преобразования, в частности подстройка смещения нуля выходного сигнала, подстройка чувствительности, полосы пропускания, величины синфазного напряжения. Программирование микросхемы осуществляется по однонаправленному интерфейсу UART, совмещенному с выходом микросхемы.

Основные характеристики:

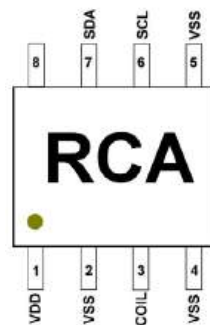
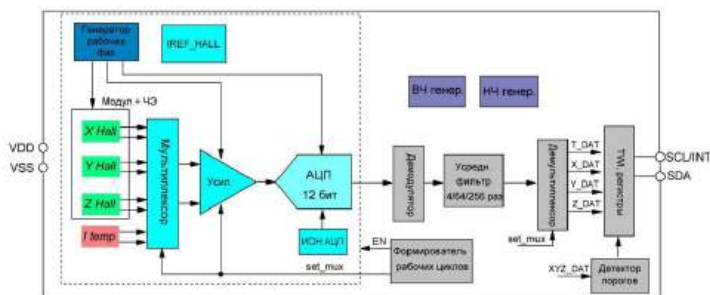
- КМОП технология производства АО «Микрон».
- Подстройка смещения нуля, чувствительности и сохранение настройки в FUSE памяти.
- Ратнометрический выходной сигнал.
- Чувствительность: от 8 мВ/мТл до 26 мВ/мТл.
- Диапазон рабочих температур: -60°C/+125°C, напр. Питания 4.5В/ 5.5В.
- Исполнение: SOT-23-3 (2.9мм* 2.9мм).

Применение

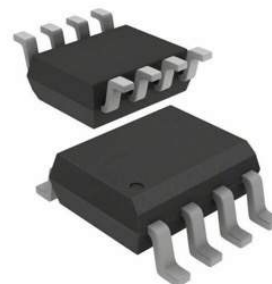
- Датчики тока и напряжения
- Датчики скорости
- Датчики положения
- Контроль величины магнитного поля

K1949ЧЭ4У

Микросхема трехосевого датчика магнитного поля
с цифровым выходом I2C



Обозначение выводов микросхемы.
Вид сверху, корпус SO-8 (5мм*5.7мм)



Серия: 2027 год

Зарубежные аналоги:
TLE493D



1 уровень локализации

Основные характеристики:

- Измерение магнитного поля по 3 осям (XYZ), в диапазоне ± 350 мТл.
- Встроенная диагностика тракта преобразования и чувствительных элементов.
- Программируемый режим энергопотребления/быстродействия.
- Встроенный детектор порога, по всем осям измерения магнитного поля.
- Встроенный датчик температуры.
- Формирование сигнала прерывания для внешнего микроконтроллера.
- Диапазон рабочих температур: $-40^{\circ}\text{C}/+125^{\circ}\text{C}$, напр. питания 2.97В/ 3.6В.
- Последовательный интерфейс I2C, совмещенный с сигналом прерывания.
- 2 байтный и 1 байтный протокол обмена с master устройством.
- Исполнение SO-8 (5мм*5.7мм).



Электронный каталог
микросхем специального
назначения



Электронный каталог
микросхем промышленного
назначения

124460, Россия, Москва, Зеленоград,
Ул. Академика Валиева, дом 6, стр. 1
8 800 200 7129
globalsales@mikron.ru
www.mikron.ru